

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

09.06.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 6月13日
Date of Application:

出願番号 特願2003-170051
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP2003-170051]

出願人 独立行政法人理化学研究所
Applicant(s):

REC'D 10 SEP 2004

WIPO

PCT

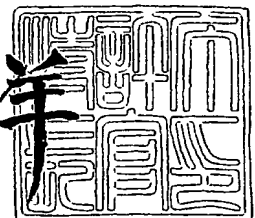
PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 8月26日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川

洋



【書類名】 特許願

【整理番号】 A35048H

【提出日】 平成15年 6月13日

【あて先】 特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】 田代 英夫

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】 近藤 恭光

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】 橘内 徳司

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】 畠山 哲

【特許出願人】

【識別番号】 000006792

【氏名又は名称】 理化学研究所

【代理人】

【識別番号】 110000109

【氏名又は名称】 特許業務法人特許事務所サイクス

【代表者】 今村 正純

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 170347

【納付金額】 21,000円

【その他】 国等の委託研究（文部科学省 科学技術振興調整費ゲノムフロンティア開拓研究推進制度「次世代DNAマイクロアレイシステムの開発」）の成果に係る特許出願（産

業再生法第 3 0 条の適用を受けるもの)

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0205404

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 生体分子マイクロアレイ用基板、生体分子マイクロアレイ、相互作用促進用装置および方法、ならびに、相互作用の検出方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板表面に、生体分子固定化用スポットを 1 つ以上有する生体分子マイクロアレイ用基板であって、

前記生体分子固定化用スポットが、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有し（以下、「突出スポット部」という）、かつ

少なくとも、前記突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側面、およびスポット用平面が、導電性物質からなることを特徴とする基板。

【請求項 2】 前記突出スポット部周辺の基板表面が、略 V 字型底面を形成する請求項 1 に記載の基板。

【請求項 3】 基板表面に、生体分子固定化用スポットを 1 つ以上有する生体分子マイクロアレイ用基板であって、

前記生体分子固定化用スポットが、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有し（以下、「突出スポット部」という）、

隣り合う突出スポット部は、突出スポット部側面によって隣接しており、かつ

、

少なくとも、前記突出スポット部側面およびスポット用平面が、導電性物質からなることを特徴とする基板。

【請求項 4】 前記導電性物質が、金、ニッケル、白金、銀、チタン、アルミニウム、ステンレス、銅、導電性酸化物、または導電性プラスチックである請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載の基板。

【請求項 5】 前記基板は、基板全体が導電性物質からなるか、または、基板表面に導電性物質被覆層を有する請求項 1 ～ 4 のいずれか 1 項に記載の基板。

【請求項 6】 前記導電性被覆層を有する基板が、ガラス、金属、シリコン、またはプラスチックからなる請求項 5 に記載の基板。

【請求項 7】 前記突出スポット部の高さが、 $10 \sim 500 \mu\text{m}$ である請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載の基板。

【請求項 8】前記突出スポット部頂上のスポット用平面と前記突出スポット部側面とのなす角が、90度以上である請求項 1～7 のいずれか 1 項に記載の基板。

【請求項 9】前記スポット用平面が粗面化されている請求項 1～8 のいずれか 1 項に記載の基板。

【請求項 10】請求項 1～9 のいずれか 1 項に記載の基板および生体分子を含み、生体分子は、前記基板上の少なくともスポット用平面に固定化されていることを特徴とする生体分子マイクロアレイ。

【請求項 11】前記生体分子は、DNA、RNA、PNA、蛋白、ポリペプチド、糖化合物、脂質、天然低分子、および合成低分子からなる群から選ばれる少なくとも一種である請求項 10 に記載の生体分子マイクロアレイ。

【請求項 12】基板上に 1 つ以上の生体分子固定化スポットを有する生体分子マイクロアレイ、

前記マイクロアレイの生体分子固定化スポットを有する面に対向するように設けられた電極、および

前記マイクロアレイと前記電極との間に電界を印加するための電源を有する、生体分子の相互作用促進用装置であって、

前記生体分子マイクロアレイを構成する基板は、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有する生体分子固定化用スポット（以下、「突出スポット部」という）を有し、

少なくとも前記突出スポット部は導電性物質表面を有し、

前記スポット用平面の導電性物質表面に生体分子が固定化され、前記生体分子固定化スポットが形成されており、かつ

前記基板は、前記基板上の突出スポット部以外の表面に、前記突出スポット部の導電性物質表面と通電可能な端子を有することを特徴とする、生体分子の相互作用促進用装置。

【請求項 13】前記基板上の突出スポット部以外の表面は、導電性物質被覆層を有し、前記端子は、前記導電性物質被覆層に含まれるか、または、前記導電性物質被覆層と通電可能であり、かつこの導電性物質被覆層と突出スポット部の導電性物質表面とは、一体の導電性物質被覆層として設けられている請求項 12 に記

載の装置。

【請求項 14】前記生体分子マイクロアレイが、請求項 10 または 11 に記載の生体分子マイクロアレイである請求項 12 または 13 に記載の装置。

【請求項 15】前記スポット用平面と電極との距離が、 $1 \sim 500 \mu\text{m}$ である請求項 12 ～ 14 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 16】前記マイクロアレイと電極との間に、非導電性スペーサーを有する請求項 12 ～ 15 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 17】前記マイクロアレイの生体分子スポットを有する面に対向するように設けられた電極が、透明電極である請求項 12 ～ 16 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 18】温度制御手段を更に有する請求項 12 ～ 17 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 19】請求項 12 ～ 18 のいずれか 1 項に記載の装置を用いる、生体分子の相互作用促進方法であって、

前記マイクロアレイと電極との間に、ターゲット生体分子を含む溶液を配置し、かつ、

前記マイクロアレイと電極との間に電界を印加することを特徴とする、生体分子の相互作用促進方法。

【請求項 20】前記マイクロアレイと電極との間に印加される電界が、 $0.001 \sim 10 \text{ MV/m}$ である請求項 19 に記載の方法。

【請求項 21】前記ターゲット生体分子が、蛍光標識されている請求項 19 または 20 に記載の方法。

【請求項 22】ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれているか、または、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれていた請求項 10 または 11 に記載のマイクロアレイの各生体分子固定化スポット上の生体分子と前記ターゲット生体分子との間の相互作用を、共焦点型検出器によって検出することを特徴とする生体分子の相互作用の検出方法。

【請求項 23】前記マイクロアレイは、請求項 19 ～ 21 のいずれか 1 項に記載の方法を用いて、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれているか

、または、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれていた、請求項 2 2 に記載の方法。

【請求項 2 4】前記固定化スポット上の生体分子および／または前記ターゲット生体分子が蛍光標識されている請求項 2 2 または 2 3 に記載の方法。

【請求項 2 5】前記共焦点型検出器によって、マイクロアレイ表面の突出スポット部とそれ以外の部分の高さおよび／または形状の差による反射光強度の相違から、マイクロアレイ上の前記突出スポット部を反射像として検出する請求項 2 2 ～ 2 4 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 2 6】前記反射像として検出された突出スポット部からの蛍光を検出することにより、生体分子の相互作用を検出する請求項 2 5 に記載の検出方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、生体分子固定の定量化及びデジタル解析が可能な生体分子マイクロアレイ用基板、前記基板に生体分子が固定されていることを特徴とする生体分子マイクロアレイ、前記マイクロアレイを用いる、生体分子の相互作用促進用装置および相互作用促進方法、ならびに、生体分子の相互作用の検出方法に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

遺伝子診断や病原菌の特定、あるいは一塩基多型の検出等、ある種の核酸(ターゲット核酸)を検出する目的で、プローブ核酸とターゲット核酸とのハイブリダイゼーションが利用されている。近年、多数のプローブ核酸を基板に固定した DNA チップや DNA マイクロアレイが実用されるようになり、ターゲット核酸の検出に使用されている。

【0 0 0 3】

DNA チップや DNA マイクロアレイの作製においては、基板に DNA を多数スポットとして整列させて固定化する必要がある。DNA の固定化には、例えば、チオールを一本鎖 DNA に接合させ、チオール化した一本鎖 DNA を、例えば、金属基板に固定化する方法が取られている。そして、固定化された DNA に被

検体であるターゲットDNAを作用させ、ハイブリダイゼーションの有無を検出する。ハイブリダイゼーションの有無は、例えば、蛍光法を用いて、ターゲットDNAとハイブリダイズした固定化DNAのスポットの蛍光を測定することによって検出することができる。

【0004】

スポットティング型のDNAマイクロアレイは、プローブDNAを含む液滴を基板上に載せて乾かすことによって作製される（非特許文献1参照）。そのため、安価に作製できるという利点がある反面、基板上に固定されるDNAの均一さが保証されない、すなわち、DNA検出スポット部の寸法や形状がばらつくという欠点がある。これらの欠点は、例えばDNA固定化基板において基板全面にDNA固定化处理（PLL処理）がされていることや、また基板面が平らであることなどに起因する。

【0005】

さらに、スポットティング型のDNAマイクロアレイの場合、DNA検出スポット部の周囲に付着した固相化剤の存在により、ターゲットDNAが非特異的に基板上に吸着し、ノイズの上昇を引き起こし、S/N比を低下させるという問題もあった（非特許文献1参照）。

【0006】

また、蛍光測定時において、蛍光部分を特定するグリッディングという操作が行われる。グリッディングは、アレイ上のスポットの縦横の数やスポット間隔、スポットの直径の大きさを入力し、スポットを円で囲む操作をいう（非特許文献1参照）。しかし、スタンプ形状および位置が安定していないと、蛍光解析時のグリッディング操作に非常に時間がかかる上、正確な解析が困難となる。また、グリッディングは、スポットの位置がずれているとスポットを正確に囲むことが出来ないため、ソフトウェアに、自動で位置を補正する機能が付いている。しかるに、すべての操作が自動になっているわけではなく、手動でスポットの開始点の設定や目視によりすべてのスポットのグリッドを確認し補正する必要がある。この操作は非常に煩雑であり、DNAスポットの数が数千以上になると非常に時間がかかる作業となり、解析スピードを遅らせる要因となっている。

【0007】

一方、基板上に固定化されたプローブDNAと試料ターゲットDNAをハイブリダイゼーションさせるには、通常、十数時間要し、しかも、多量の試料ターゲットDNAが必要とされる。そのため、ハイブリダイゼーション時間および大量の試料の調製に、莫大な時間と費用、労力が必要とされている。特に、低発現遺伝子の解析を行う場合、極めて多くのターゲット試料が必要となる。

【0008】

【非特許文献1】「必ずデータが出るDNAマイクロアレイ実践マニュアル 基本原理、チップ作製技術からバイオインフォマティクスまで」、第1版、羊土社、2002年12月1日、p. 19-21、35、106-108

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

そこで本発明の目的は、生体分子マイクロアレイに一定形状の生体分子固定化領域をもつ基板及び生体分子の相互作用、特に核酸のハイブリダイゼーションを高速に行い、かつ微量サンプルの相互作用を促進させ、さらに高速・高感度に相互作用を検出し解析する手段を提供することである。

更に、本発明は、生体分子の相互作用を促進して、相互作用し得る生体分子間で効率的に相互作用を形成させることができる相互作用促進用装置および方法を提供することを目的とする。

更に、本発明は、グリッディング操作を自動で行う手段を提供することにより、生体分子マイクロアレイからの蛍光データの収集およびデジタル解析の自動化を可能にすることを目的とする。

より詳しくは、本発明は、高感度で生体分子の相互作用を検出でき、好ましくは、併せてグリッティングを自動で行うこともできる生体分子マイクロアレイ用基板、そのような基板に生体分子が固定化された生体分子マイクロアレイを提供することを目的とする。

更に、本発明は、グリッティングを自動で行うことを可能にする生体分子の相互作用の検出方法を提供することを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】

上記本発明の目的を達成するための手段は、以下の通りである。

(1) 基板表面に、生体分子固定化用スポットを1つ以上有する生体分子マイクロアレイ用基板であって、

前記生体分子固定化用スポットが、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有し（以下、「突出スポット部」という）、かつ

少なくとも、前記突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側面、およびスポット用平面が、導電性物質からなることを特徴とする基板。

(2) 前記突出スポット部周辺の基板表面が、略V字型底面を形成する(1)に記載の基板。

(3) 基板表面に、生体分子固定化用スポットを1つ以上有する生体分子マイクロアレイ用基板であって、

前記生体分子固定化用スポットが、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有し（以下、「突出スポット部」という）、

隣り合う突出スポット部は、突出スポット部側面によって隣接しており、かつ

、

少なくとも、前記突出スポット部側面およびスポット用平面が、導電性物質からなることを特徴とする基板。

(4) 前記導電性物質が、金、ニッケル、白金、銀、チタン、アルミニウム、ステンレス、銅、導電性酸化物、または導電性プラスチックである(1)～(3)のいずれかに記載の基板。

(5) 前記基板は、基板全体が導電性物質からなるか、または、基板表面に導電性物質被覆層を有する(1)～(4)のいずれか1項に記載の基板。

(6) 前記導電性被覆層を有する基板が、ガラス、金属、シリコン、またはプラスチックからなる(5)に記載の基板。

(7) 前記突出スポット部の高さが、10～500 μm である(1)～(6)のいずれかに記載の基板。

(8) 前記突出スポット部頂上のスポット用平面と前記突出スポット部側面とのなす角が、90度以上である(1)～(7)のいずれかに記載の基板。

(9) 前記スポット用平面が粗面化されている(1)～(8)のいずれかに記載

の基板。

(10) (1) ~ (9) のいずれか1項に記載の基板および生体分子を含み、生体分子は、前記基板上の少なくともスポット用平面に固定化されていることを特徴とする生体分子マイクロアレイ。

(11) 前記生体分子は、DNA、RNA、PNA、蛋白、ポリペプチド、糖化合物、脂質、天然低分子、および合成低分子からなる群から選ばれる少なくとも一種である(10)に記載の生体分子マイクロアレイ。

(12) 基板上に1つ以上の生体分子固定化スポットを有する生体分子マイクロアレイ、

前記マイクロアレイの生体分子固定化スポットを有する面に対向するように設けられた電極、および

前記マイクロアレイと前記電極との間に電界を印加するための電源を有する、生体分子の相互作用促進用装置であって、

前記生体分子マイクロアレイを構成する基板は、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有する生体分子固定化用スポット（以下、「突出スポット部」という）を有し、

少なくとも前記突出スポット部は導電性物質表面を有し、

前記スポット用平面の導電性物質表面に生体分子が固定化され、前記生体分子固定化スポットが形成されており、かつ

前記基板は、前記基板上の突出スポット部以外の表面に、前記突出スポット部の導電性物質表面と通電可能な端子を有することを特徴とする、生体分子の相互作用促進用装置。

(13) 前記基板上の突出スポット部以外の表面は、導電性物質被覆層を有し、前記端子は、前記導電性物質被覆層に含まれるか、または、前記導電性物質被覆層と通電可能であり、かつこの導電性物質被覆層と突出スポット部の導電性物質表面とは、一体の導電性物質被覆層として設けられている(12)に記載の装置。

(14) 前記生体分子マイクロアレイが、(10)または(11)に記載の生体分子マイクロアレイである(12)または(13)に記載の装置。

(15) 前記スポット用平面と電極との距離が、 $1 \sim 500 \mu\text{m}$ である (12) ~ (14) のいずれかに記載の装置。

(16) 前記マイクロアレイと電極との間に、非導電性スペーサーを有する (12) ~ (15) のいずれかに記載の装置。

(17) 前記マイクロアレイの生体分子スポットを有する面に対向するように設けられた電極が、透明電極である (12) ~ (16) のいずれかに記載の装置。

(18) 温度制御手段を更に有する (12) ~ (17) のいずれかに記載の装置。

(19) (12) ~ (18) のいずれかに記載の装置を用いる、生体分子の相互作用促進方法であって、

前記マイクロアレイと電極との間に、ターゲット生体分子を含む溶液を配置し、かつ、

前記マイクロアレイと電極との間に電界を印加することを特徴とする、生体分子の相互作用促進方法。

(20) 前記マイクロアレイと電極との間に印加される電界が、 $0.001 \sim 10 \text{ MV/m}$ である (19) に記載の方法。

(21) 前記ターゲット生体分子が、蛍光標識されている請求項 19 または 20 に記載の方法。

(22) ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれているか、または、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれていた (10) または (11) に記載のマイクロアレイの各生体分子固定化スポット上の生体分子と前記ターゲット生体分子との間の相互作用を、共焦点型検出器によって検出することを特徴とする生体分子の相互作用の検出方法。

(23) 前記マイクロアレイは、(19) ~ (21) のいずれかに記載の方法を用いて、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれているか、または、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれていた、(22) に記載の方法。

(24) 前記固定化スポット上の生体分子および／または前記ターゲット生体分子が蛍光標識されている (22) または (23) に記載の方法。

(25) 前記共焦点型検出器によって、マイクロアレイ表面の突出スポット部と

それ以外の部分の高さおよび／または形状の差による反射光強度の相違から、マイクロアレイ上の前記突出スポット部を反射像として検出する（22）～（24）のいずれかに記載の方法。

（26）前記反射像として検出された突出スポット部からの蛍光を検出することにより、生体分子の相互作用を検出する（25）に記載の検出方法。

【0011】

【発明の実施の形態】

以下、本発明について更に詳細に説明する。

【基板】

本発明の生体分子マイクロアレイ用基板は、基板表面に、生体分子固定化用スポットを1つ以上有する生体分子マイクロアレイ用基板であって、前記生体分子固定化用スポットが、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有する（以下、「突出スポット部」という）。更に、本発明の生体分子マイクロアレイ用基板は、少なくとも、前記突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側面、およびスポット用平面が、導電性物質からなるか（以下、「第一の態様」という）、または、隣り合う突出スポット部は、突出スポット部側面によって隣接しており、かつ、少なくとも、前記突出スポット部側面およびスポット用平面が、導電性物質からなる（以下、「第二の態様」という）ことを特徴とする。

本発明の基板では、生体分子固定化用スポットが、突出スポット部の頂上の平面に設けられている。そのため、本発明の第一の態様の基板では、前記突出スポット部頂上のスポット用平面（生体分子固定化用スポット）は、前記突出スポット部周辺の基板表面より一段高い位置にあり、両者間に高低差が生じる。

【0012】

一方、本発明において、生体分子の相互作用の検出に用いられる共焦点型検出器は、試料上の焦点面からの反射光や蛍光を、光学系の結像面に置かれたピンホールに通して検出する。図1に、本発明で使用する共焦点型検出器10の光学系の概略図を示す。図1の実線aは、入射光を表す。実線bは、焦点面からの反射光または蛍光を表し、破線は、非焦点面からの反射光または蛍光を表す。共焦点型検出器10では、マイクロアレイ1上の焦点面から反射した反射光、および

、試料上の焦点面から放出された蛍光は、対物レンズ 2 を通ってビームスプリッター 3 へ入射し、ビームスプリッター 3 によって、検出レンズ 4 へ垂直に入射するように光路が修正され、検出レンズ 4 を経て、結像面 5 へ入射する。共焦点型検出器 10 は、試料上での焦点が、結像面でも焦点となるように設計されている。よって、試料上の焦点面からの光は、結像面 5 で焦点を結び、ピンホール 6 を通過して、検出部 7 で検出される。一方、試料上の非焦点面からの光は、結像面 5 で焦点を結ばないため、大部分がピンホール 6 を通過せず、検出部 7 において検出されない。このように、共焦点型検出器によれば、焦点面からの光を、選択的に検出することができる。

【0013】


本発明の第一の態様の基板では、前記突出スポット部周辺の基板表面と、前記突出スポット部頂上のスポット用平面（生体分子固定化用スポット）との高低差が、生体分子とターゲット生体分子との相互作用の検出において使用する共焦点型検出器の焦点深度以上であれば、共焦点型検出器の焦点を、突出スポット部頂上のスポット用平面の高さに合わせることで、検出器において、突出部周辺の基板表面からの蛍光や反射光よりも、突出スポット部頂上のスポット用平面からの蛍光や反射光を、より高い強度で検出することができる。従って、本発明の基板の突出スポット部頂上のスポット用平面に生体分子を固定化したマイクロアレイでは、スポット上の情報、例えば、ターゲット生体分子との相互作用の有無を、高感度で検出することができる。

【0014】

本発明の第二の態様の基板は、隣り合う突出スポット部が、突出スポット部側面によって隣接しており、かつ、少なくとも、前記突出スポット部側面およびスポット用平面が、導電性物質からなることを特徴とする。本発明の第二の態様の基板の一例を、図 5 に示す。

【0015】

本発明の第一および第二の態様の基板において、前記突出スポット部頂上のスポット用平面と前記突出スポット部側面とのなす角は、90度以上であることが好ましい。好ましくは、90～135度である。図 2（a）は、本発明の基板の



一部の断面図である。ここで、「突出スポット部頂上のスポット用平面と突出スポット部側面とのなす角」とは、図 2 (a) における角度 θ をいう。角度 θ は、例えば、突出スポット部を、突出スポット部周辺の基板表面に対して垂直に切断し、その断面から求めることができる。

【0016】

このように、本発明の基板において、突出スポット部頂上のスポット用平面と突出スポット部側面とのなす角が 90 度以上であることにより、即ち、突出スポット部底面の大きさが、突出スポット部頂上のスポット用平面の大きさ以上であることにより、グリッティングを自動で行って、生体分子固定化用スポットの位置および大きさを特定することができるという利点がある。以下に、この点について、詳述する。

【0017】

図 2 (a) に示すように、突出スポット部頂上のスポット用平面と突出スポット部側面とのなす角が 90 度以上である場合、共焦点型の検出器を使用して反射光を検出する際に、突出スポット部頂上のスポット用平面に対して垂直な方向から照射した光（図 2 (a) に矢印で表される光）に対する突出スポット部側面からの反射光は、入射光と同一方向には反射しない。一方、突出スポット部頂上のスポット用平面からの反射光は、入射光と同一方向に反射する。このため、共焦点型検出器では、突出スポット部頂上のスポット用平面からの反射光のみが検出され、側面からの反射光は検出されない。こうして得られた反射像には、突出スポット部頂上のスポット用平面に相当する像が、反射像として得られ、突出スポット部側面に相当する部分は、反射光がほとんど検出されないで黒色の縁取りとして表れる。この反射像では、黒い縁取りの内部が生体分子スポットに相当するため、この反射像により、スポットの大きさおよび位置を特定することができる。本発明では、このような原理により、自動グリッティングを行うことが可能である。

【0018】

また、本発明の第一の態様の基板において、突出スポット部の高さが相互作用の検出に使用する共焦点型検出器の焦点深度以上である場合は、共焦点型検出器

の焦点を、突出スポット部頂上のスポット用平面の高さに合わせれば、突出スポット部周辺の基板表面からの反射光は、焦点が合わないため、突出スポット部頂上のスポット用平面からの反射光よりもはるかに弱い強度でしか、検出されない。本発明では、この高低差を利用して自動グリッティングを行うことも可能である。但し、前記突出スポット部の高さが相互作用の検出に使用する共焦点型検出器の焦点深度より小さい場合であっても、前述のように、反射像において、突出スポット部側面に相当する部分が黒色の縁取りとして表れれば、スポットの大きさおよび位置を特定することが可能である。

【0019】

また、本発明の第一の態様の基板では、前記突出スポット部頂上のスポット用平面と突出スポット部側面とのなす角が90度未満であっても、突出スポット部の高さが相互作用の検出に使用する共焦点型検出器の焦点深度以上である場合は、スポット用平面と、突出スポット部周辺の基板表面との高低差を利用して、反射像によって、スポット用平面の位置および大きさを特定し、自動でグリッティングを行うことができる。前記突出スポット部頂上のスポット用平面と突出スポット部側面とのなす角が90度である場合、前記突出スポット部の形状は、例えば、円柱状または角柱状であることができる。

【0020】

さらに、本発明の第一の態様の基板は、前記突出スポット部頂上のスポット用平面と前記突出スポット部側面とのなす角が、90度以上であり、かつ、前記突出スポット周辺の基板表面が、略V字型底面を形成する基板であることもできる。このような基板では、共焦点型検出器で検出されるスポット用平面からの反射光強度が、基板上のスポット用平面以外の部分からの反射光強度より強くなるため、この反射光強度の違いにより、スポット用平面の位置および大きさを特定することができる。図4は、「略V字型底面」を有する基板の一部の拡大図である。本発明において、「略V字型底面」とは、例えば、隣り合う突出スポット部間の突出スポット部周辺の基板表面が平面ではなく、図4に示すように、略V字を形成していることをいう。

【0021】

更に、本発明の第一の態様の基板は、少なくとも、前記突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側面、およびスポット用平面が、導電性物質からなることを特徴とする。製造の容易さや製造コストを考慮すれば、本発明の第一の態様の基板は、基板上の、前記突出スポット周辺以外の基板表面も、導電性物質からなるものであることが好ましい。また、本発明の第二の態様の基板は、少なくとも突出スポット部側面および突出スポット部平面が、導電性物質からなることを特徴とする。

【0022】

本発明では、前記のように、第一の態様の基板においては、少なくとも、突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側面、およびスポット用平面が、第二の態様の基板においては、少なくとも、突出スポット部側面およびスポット用平面が、導電性物質からなることにより、後述するように、前記基板に対向する電極を設け、電界を印加することによって、スポット用平面に固定化された生体分子とターゲット生体分子との相互作用を促進することができる。例えば、ターゲット生体分子の濃度が低い場合でも、良好な相互作用結果を得ることができ、また、濃度が同一の場合には、より短時間で所定の相互作用結果を得ることができる。

【0023】

また、本発明では、前記導電性物質が、光を反射する性質を有するものであれば、反射光によって、生体分子固定化スポットの大きさおよび位置を特定し、自動でグリッティングを行うことができる。この点については後述する。

【0024】

本発明において、前記突出スポット部の高さは、相互作用の検出において使用する共焦点型検出器の焦点深度以上の高さになるように、適宜設定することができる。通常、共焦点型検出器の焦点深度を考慮すると、例えば、 $10 \sim 500 \mu\text{m}$ であることができる。但し、前述のように、基板上の突出スポット部頂上のスポット用平面とそれ以外の部分との形状の差による反射光強度の相違を検出することによって自動グリッティングを行う場合は、前記突出スポット部の高さは、相互作用の検出に使用する共焦点型検出器の焦点深度より小さくても、自動グリッ

ティングが可能である。この点については、後述する。

また、前記突出スポット部の高さを決定する際は、生体分子のスポット形成（スタンピング）に使用するニードルの直径や、プローブ核酸等の生体分子溶液のスポット量も考慮する必要がある。例えば、直径 $100\text{ }\mu\text{m}$ の円形の突出スポット部に対して直径 $130\text{ }\mu\text{m}$ 程度のニードルを用いて生体分子をスポットする場合、突出スポット部の高さが $15\text{ }\mu\text{m}$ 以上であれば、表面張力のため、突出スポット部頂上のスポット用平面から生体分子溶液が流れ出すことなく、固定化用スポットのみに、生体分子が固定化されるため、好ましい。

【0025】

本発明の基板において、突出スポット部頂上のスポット用平面の形状は、スポットされた生体分子を保持し得る形状であれば、いずれの形状であることもでき、例えば、円形や正方形であることができる。前記スポット用平面の大きさは、スポットに用いるニードルやスポットする生体分子溶液の量に応じて適宜設定することができ、例えば、 $10\sim500\text{ }\mu\text{m}$ とすることができる。ここで、「スポット用平面の大きさ」とは、例えば、スポット用平面の形状が円形の場合は、その直径をいい、スポット用平面の形状が正方形の場合は、その一辺の長さをいう。

突出スポット部底面の形状は、特に限定されないが、製造の容易さ等を考慮すれば、スポット用平面と同様の形状であることが好ましい。図2（b）は、本発明の基板上の突出スポット部の概略図である。ここで、「突出スポット部底面の形状」とは、図2（b）の斜線部をいう。

【0026】

前記突出スポット部頂上のスポット用平面は、粗面化されていてもよい。例えば、前記突出スポット部頂上のスポット用平面は、深さ方向と略水平方向に、相互作用の検出において使用する共焦点型検出器の焦点深度以内の深さの凹凸を有していてもよい。図3に、粗面化されたスポット用平面の一例（部分拡大図）を示す。粗面化されたスポット用平面の一例としては、図3に示すような、数 μm 角の格子状の形状を設けたスポット用平面を挙げることができる。このように、スポット用平面が粗面化されていることにより、後述するように、電気泳動また

は誘電泳動によるターゲット生体分子の濃縮効果を得る場合に、凹凸の角（エッジ）部分に強電界が生じ、相互作用が更に促進されるという利点がある。

【0027】

スポット用平面の粗面化方法は特に限定されず、例えば、本発明の基板がプラスチック成型基板の場合、フォトリソグラフィによりエッチングした母材を、電鍍法により反転写した微細加工金型を用いることにより、スポット用平面が粗面化された基板を製作することができる。

【0028】

本発明の基板は、基板全体が導電性物質からなるか、また、基板表面に導電性物質被覆層を有するものであることができる。

前述のように、反射像によって自動グリッティングを行う場合には、前記導電性物質は、光を反射する性質を有する物質から選択する。

また、金属とチオール基との結合を利用して、プローブ核酸の固定化を行う場合は、前記導電性物質は、チオール基と結合性を有する金属から選択する。

【0029】

前記導電性物質としては、例えば、金属（例えば、金、ニッケル、白金、銀、チタン、アルミニウム、ステンレス、銅）、導電性酸化物（例えば、 In_2O_5 ／ SnO_2 ）および導電性プラスチック（例えば、ポリアセチレン）を挙げることができる。

また、導電性物質被覆層を有する基板としては、ガラス、シリコン、プラスチック、具体的には、ポリプロピレン等の基板の表面に、前記導電性物質を被覆したものを挙げることができる。基板上の導電性物質被覆層の厚さは、特に限定されるものではなく、例えば、 $0.1 \sim 10 \mu\text{m}$ とすることができる。

【0030】

本発明において、前記基板が、金属からなるものである場合は、所望の形状の突出スポット部に対応した凹部を有する鋳型に、熔融した金属を注入して鋳造することにより、本発明の基板を得ることができる。また、プレス成形によって、金属製基板を得ることもできる。本発明の基板は、金属からなる基板の上に、導電性物質を被覆したものであることもできる。

【0031】

本発明の基板が、シリコンまたはプラスチック製の基板上に導電性物質の被覆を有するものである場合は、例えば、所望の形状の突出スポット部に対応した凹部を有する成形型を用いてシリコンまたはプラスチックを成形し、そのシリコンまたはプラスチック製の基板上に、導電性物質を、蒸着、メッキ等によって被覆することにより、本発明の基板を得ることができる。

【0032】

また、本発明の基板は、平板状の基板上に導電性被覆層を被覆した後に、エッチング等により突出スポット部を形成することによって製造することもできる。

【0033】

次に、本発明の基板が、ガラス基板上に金被覆層を有するものである場合の、基板の製造方法の一例を説明する。但し、本発明はこの態様に限定されるものではない。

まず、スライドガラスの表面に、真空蒸着装置により、クロム、チタン、ニッケル等を蒸着し、次いで、その上に金を蒸着する。この金蒸着スライドガラス上に、ポジ型レジストをスピンコーターで塗布し、例えば60℃でオーブンにより1時間ベーキングする。

次いで、紫外線露光装置により、フォトマスクを通してスライドガラスに紫外線を照射する。このとき、フォトマスクとしては、所望の形状の突出スポット部に対応したパターンを有するものを使用する。紫外線照射後、現像液によって現像を行えば、金蒸着スライドガラス表面に、レジストパターンを形成することができる。

【0034】

次いで、レジストパターン周辺の金表面を、金エッチャントによってエッチングする。金エッチング後の基板を超純水によって洗浄した後、金の下に蒸着されたクロム、チタン、ニッケル等を除去するために、エッチャントにより更にエッチングを行い、超純水によって洗浄する。

アセトン等によってレジストを溶解した後、超純水によって洗浄し、更に残っているレジストを完全に除去するために、ピラニア溶液（硫酸：過酸化水素＝1

: 1) に例えば 10 分間漬けて、超純水で洗浄する。これにより、フォトマスクに対応した金パターンを有するガラス基板を得ることができる。

【0035】

次に、上記基板を、フッ化水素酸に浸漬し、露出しているガラス表面をエッチングする。このときに使用するフッ化水素酸の濃度および浸漬時間は、所望の突出スポット部の高さに応じて適宜設定することができる。

【0036】

次に、前述と同様に、金およびクロム等のエッチングを行った後、ピラニア溶液および超純水によって基板を洗浄し、所望の形状の突出スポット部を有するガラス基板を得ることができる。

このガラス基板に、前述と同様に、クロム等を蒸着し、次いで、金を蒸着することによって、突出部を有し、かつ、金被覆を有する基板を得ることができる。

【0037】

本発明において、基板全体の大きさ、基板上の突出スポット部の数および集積度は特に限定されず、適宜設定することができる。例えば、本発明の基板は 10 ~ 20, 000 mm² の大きさの基板上に、突出スポット部を、10 ~ 50, 000 個程度有するものであることができる。

【0038】

[生体分子マイクロアレイ]

本発明の核酸マイクロアレイは、本発明の基板および生体分子を含み、生体分子は、前記基板上の少なくともスポット用平面に固定化されていることを特徴とする生体分子マイクロアレイである。前記生体分子は、DNA、RNA、PNA、蛋白、ポリペプチド、糖化合物、脂質、天然低分子、および合成低分子からなる群から選ばれる少なくとも一種であることができ、目的に応じて選択することができる。

ここで、糖化合物としては、例えば、単糖、オリゴ糖、多糖、糖鎖複合体、糖蛋白質、糖脂質、およびそれら誘導体などを挙げることができる。

脂質としては、例えば、脂肪酸、リン脂質、糖脂質、グリセリドなどを挙げることができる。

天然低分子としては、例えば、ホルモン分子や抗生物質、毒物、ビタミン類、生理活性物質、二次代謝産物などを挙げることができる。

合成低分子としては、例えば、天然低分子の合成物、およびそれら誘導体などを挙げることができる。

【0039】

本発明では、生体高分子が核酸であり、かつ、前記導電性物質が金属である場合、プローブ核酸を生体分子固定化用スポット（突出スポット部）に固定化するために、突出スポット部頂上のスポット用平面の金属と反応性を有する基を一端に有する核酸を含む溶液を、スポッティング溶液として用いることができる。そのような基としては、チオール基を挙げることができる。チオール基を有する核酸鎖の金属表面への固定化は、公知の方法によって行うことができ、例えば、J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 9787-9792を参照することができる。

【0040】

金属表面へのDNAの固定化方法としては、金属（表面酸化被膜を活性化させ水酸基を提示させたもの）に対して以下の処理を行う方法を用いることもできる。

- (1) アミノシラン処理した基板表面に、UV照射することにより、DNAを固定化する。
- (2) アミノシラン、NHS (N-ヒドロキシスクシンイミド) -ビオチン、アビジンによって順次処理した基板表面に、ビオチン化DNAを固定化する。
- (3) アミノシラン、マレイミド-ビオチン、アビジンによって順次処理した基板表面に、ビオチン化DNAを固定化する。
- (4) アミノシラン、次いでグルタルアルデヒドによって処理した基板表面に、アミノ化DNAを固定化する。
- (5) アミノシラン、次いでカルボジイミドによって処理した基板表面に、アミノ化DNAを固定化する。
- (6) アミノシラン処理した基板表面に、カルボキシ化DNAを固定化する。
- (7) アミノシラン処理した基板表面に、リン酸化DNAを固定化する。
- (8) アミノシラン、次いでNHS-マレイミド化合物によって処理した基板表面

に、チオール化DNAを固定化する。

(9) エポキシシラン処理した基板表面に、アミノ化DNAを固定化する。

(10) チオールシラン処理した基板表面に、チオール化DNAを固定化する。

【0041】

また、DNA以外の生体分子についても、上記のような、UV照射による固定化や、チオール基、アミノ基、カルボキシル基、リン酸基などの官能基を介しての固定化が可能である。

【0042】

前記スポット用平面への生体分子溶液のスポットティングは、常法により行うことができ、例えば、先端に生体分子溶液を保持したニードルを、突出スポット部頂上のスポット用平面に接触させることにより行うことができる。ここで使用されるスポットティング用装置としては、例えば、特開 2001-46062 号公報および特開 2003-57236 号公報に記載の装置を挙げることができる。スポット量は、スポット用平面から生体分子溶液が流れ出さないように、スポット用平面の大きさや、突出スポット部の高さに応じて、適宜設定することができる。

【0043】

[相互作用促進用装置、相互作用促進方法]

本発明は更に、

基板上に1つ以上の生体分子固定化スポットを有する生体分子マイクロアレイ、

前記マイクロアレイの生体分子固定化スポットを有する面に対向するように設けられた電極、および

前記マイクロアレイと前記電極との間に電界を印加するための電源を有する、生体分子の相互作用促進用装置であって、

前記生体分子マイクロアレイを構成する基板は、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有する生体分子固定化用スポット（突出スポット部）を有し、

少なくとも前記突出スポット部は導電性物質表面を有し、

前記スポット用平面の導電性物質表面に生体分子が固定化され、前記生体分子

固定化スポットが形成されており、かつ

前記基板は、前記基板上の突出スポット部以外の表面に、前記突出スポット部の導電性物質表面と通電可能な端子を有することを特徴とする、生体分子の相互作用促進用装置

に関する。このような生体分子の相互作用としては、例えば、プローブ核酸とターゲット核酸とのハイブリダイゼーション、抗原-抗体相互作用、レセプター-リガンド相互作用、タンパク-タンパク相互作用、DNA-タンパク相互作用を挙げることができる。

前記基板上の突出スポット部以外の表面は、導電性物質被覆層を有し、前記端子は、前記導電性物質被覆層に含まれるか、または、前記導電性物質被覆層と通電可能であり、かつこの導電性物質被覆層と突出スポット部の導電性物質表面とは、一体の導電性物質被覆層として設けられていることが好ましい。前記装置における生体分子マイクロアレイは、前記本発明の生体分子マイクロアレイであることができる。

【0044】


更に、本発明は、前記の生体分子の相互作用促進用装置を用いる、生体分子の相互作用促進方法であって、

前記マイクロアレイと電極との間に、ターゲット生体分子を含む溶液を配置し、かつ、

前記マイクロアレイと電極との間に電界を印加することを特徴とする、生体分子の相互作用促進方法に関する。

【0045】

前記装置における生体分子マイクロアレイは、突出スポット部を有するため、マイクロアレイ上の突出部頂上の生体分子が固定化された平面と、前記マイクロアレイの生体分子スポットを有する面に対向するように設けられた電極（対向電極）の、前記平面と対向する面との間で電界密度が高まり、溶液中のターゲット生体分子が、電気泳動（直流電源を使用した場合）または誘電泳動（交流電源を使用した場合）によって突出部近傍に濃縮される。



これにより、突出スポット部に固定化された生体分子と、ターゲット生体分子との相互作用を促進させることができる。特に、前記生体分子マイクロアレイにおいて、生体分子が固定化されたスポット平面が粗面化されている場合、例えば、スポット平面に、共焦点型検出器の焦点深度以内で深さ方向と略水平方向に凹凸を有する場合は、凹凸の角（エッジ）部分に強電界が生じ、相互作用が更に促進されるという利点がある。

【0046】

前記対向電極は、前記生体分子マイクロアレイと対向電極との間に電界を印加することができるものであれば、特に制限はない。図6（a）に、本発明の生体分子の相互作用促進用装置の概略図を、図6（b）に、本発明の生体分子の相互作用促進用装置の断面図を示す。本発明において、対向電極は、導電性物質、例えば、金属、導電性酸化物、導電性プラスチック、等からなる基板であることができ、また、マイクロアレイと対向する面に、導電性物質被覆層を有する基板からなるものであることもできる。本発明では、特に、前記対向電極が、例えば、ITO（酸化インジウムスズ）、酸化スズなどの透明電極であれば、生体分子の相互作用中に、同時に、透明電極の上から、共焦点型検出器で反射光および蛍光の検出を行うことができ、相互作用をリアルタイムで検出することができる。また、前記生体分子マイクロアレイを構成する基板が、光透過性のガラスやプラスチック上に、透明の導電性被覆層を設けたものである場合や、基板全体が透明の導電性物質からなる場合も、同様に、相互作用をリアルタイムで検出することができる。

【0047】

また、前記相互作用促進用装置において、生体分子マイクロアレイと対向電極との間に電界を印加するための電源は、直流電源でも、交流電源でもよく、より好ましくは、交流電源が用いられる。直流電源を使用する場合は、高電圧をかけると、ターゲット生体分子溶液が高電圧により電気分解し、気泡等が発生しやすいという懸念があるため、低電圧を使用することが好ましい。ターゲット生体分子としてDNAを使用する場合には、DNAがマイナスに荷電されているため、直流電源を使用する場合は、突出スポット部側が、プラスになるように電界を印

加することが好ましい。交流電源を使用する場合は、低周波交流では、ターゲット生体分子溶液の電気分解により気泡等が発生しやすいという懸念があるため、高周波交流を使用することが好ましい。

【0048】

前記相互作用促進用装置において、生体分子マイクロアレイと対向電極との間には、生体分子マイクロアレイの突出スポット部を有する領域が覆われないように、非導電性材料からなるスペーサーを挟むことができる。前記非導電性材料としては、例えば、ゴム、ガラス、プラスチックを挙げることができる。本発明の装置では、このスペーサーの厚さにより、生体分子マイクロアレイ上のスポット用平面と対向電極との距離を設定することができ、また、このスペーサーによって囲まれた空間に、ターゲット生体分子を含む溶液を充填することができる。前記スポット用平面と対向電極との距離は、電気泳動または誘電泳動によるターゲット生体分子濃縮の効果が得られる範囲で適宜設定することができ、例えば、1～500 μm とすることができる。

【0049】

前記相互作用促進用装置は、ヒーター等の温度制御手段を更に有することが好ましい。温度制御手段によって、生体分子周辺の環境を、相互作用に適した温度に制御することにより、相互作用を更に促進することができる。

【0050】

前記装置において、生体分子マイクロアレイと対向電極との間に印加される電界は、前記の生体分子マイクロアレイと対向電極との間の距離を考慮しつつ、電気泳動または誘電泳動によるターゲット生体分子の濃縮の効果が得られる範囲で適宜設定することができ、例えば、0.001～10 MV/m とすることができる。

【0051】

本発明では、共焦点検出器によって蛍光を検出することにより生体分子間の相互作用を検出するために、前記の相互作用促進方法に用いられるターゲット生体分子は、蛍光標識されているものであることが好ましい。ターゲット生体分子の蛍光標識は、公知の方法で行うことができる。また、本発明では、マイクロアレ

イに固定化される生体分子が、蛍光標識されていてもよい。マイクロアレイに固定される生体分子の蛍光標識も、公知の方法で行うことができる。

【0052】

本発明において、ターゲット生体分子溶液に用いるバッファーとして、好ましいものとしては、約6～8付近の解離定数(pKa)を有するものが挙げられる。プローブ核酸とターゲット核酸とのハイブリダイゼーションを効率よく起こさせるためには、pHが中性域であることが好ましいため、中性域で緩衝能を有するバッファーを使用することが好ましい。具体的には、以下のバッファー物質を含むバッファーが挙げられる；ヒスチジン、MES (2-(N-モルホリン)エタンスルホン酸)、マレイン酸、3,3-ジメチルグルタル酸、炭酸、4-ヒドロキシメチルイミダゾール、クエン酸、ジメチルアミノエチルアミン、プロリン酸、グリセロール-2-リン酸、PIPES (ピペラジン-N,N'-ビス(2-エタンスルホン酸))、エチレンジアミン、イミダゾール、MOPS (3-(N-モルホリン)プロパンスルホン酸)、リン酸、TES (N-トリス(ヒドロキシメチル)メチル-2-アミノエタンスルホン酸)、4-メチルイミダゾール、HEPES (N-2-ヒドロキシエチルピペラジン-N'-2-エタンスルホン酸)、N-エチルモルホリン、トリエタノールアミン、トリス(トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン)。

【0053】

[相互作用の検出方法]

本発明は更に、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境に置かれているか、または、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境に置かれていた、本発明のマイクロアレイの各生体分子固定化スポット上の生体分子と前記ターゲット生体分子との間の相互作用を、共焦点型検出器によって検出することを特徴とする生体分子の相互作用の検出方法にも関する。共焦点型検出器による反射光および蛍光の検出原理については、前述の通りである。本発明の相互作用の検出方法では、共焦点型検出器を用いて、前述の原理で反射像によってスポットの大きさおよび位置を特定することで、自動グリッティングを行うことができる。即ち、本発明によれば、マイクロアレイ表面の生体分子固定化スポットとそれ以外の部分の高さおよび／または形状の差による反射光強度の相違から、マイクロアレイ上の生

体分子固定化スポットを、反射像として検出することができる。更に、共焦点型検出器によって、マイクロアレイからの蛍光を検出するときに、マイクロアレイ上の突出スポット部頂上のスポット平面の高さに、共焦点型検出器の焦点を合わせれば、前記スポット平面上の蛍光標識された生体分子（スポットに固定化された生体分子および／またはターゲット生体分子）からの蛍光を選択的に検出して、スポットに対応する蛍光像を得ることができる。本発明では、こうして得られた反射像と蛍光像を重ね合わせることによって、マイクロアレイ上の相互作用が起こっているスポットを特定することができ、その蛍光強度により、相互作用の程度を測定することができる。なお、本発明では、インターカレーターを用いて、インターカレーターからの蛍光を測定することによって相互作用を検出することもできる。

【0054】

特に、本発明では、反射光と蛍光とを同時に検出することができる共焦点型スキャナーを用いることが好ましい。そのような装置の一例を、図7に示す。図7に示す装置では、励起光源（レーザー）21から発生した励起光はミラー22、ダイクロックミラーミラー23、ミラー26、対物レンズ24、を介して試料（マイクロアレイ）25に照射される。反射光は対物レンズ24、ミラー26、ダイクロックミラー23（反射光の一部を透過（数パーセント以下））、ダイクロックミラー27、減光フィルター28、検出レンズ29、ピンホール30を介して反射光検出部31に導かれる。蛍光は2つのダイクロックミラー23、27を透過し、ミラー32にて反射しカットフィルター33、検出レンズ34、ピンホール35を介して蛍光検出部36に導かれる。このような装置によれば、マイクロアレイ表面の生体分子固定化スポットとそれ以外の部分の高さおよび／または形状の差による反射光強度の相違から、マイクロアレイ上の生体分子固定化スポットを反射像として検出し、同時に、そのスポットからの蛍光を検出することによって、生体分子の相互作用を検出することができる。

【0055】

【実施例】

以下、本発明を実施例によって更に説明する。

実施例1

核酸マイクロアレイ用基板の作製

- 1) 表面研磨したスライドガラスの表面に、真空蒸着装置により、クロムを250 Å厚で蒸着した後、金をその上に2500 Å厚で蒸着した。
- 2) 金蒸着スライドガラス上にポジ型レジストS1813（シプレー社）をスピナーコーターで塗布し、60℃オープンにより1時間ベーキングした。
- 3) 紫外線露光装置により、フォトマスクを通して上記スライドガラスに紫外光を照射した。フォトマスクは、直径200 μmの円と1辺200 μmの正方形のパターンがそれぞれ11×11個形成されているものを使用した。照射後、現像液CD-26（シプレー社）により現像を行い、直径約200 μmの円と正方形のレジストパターンを金表面上に形成した。
- 4) 円と正方形のレジストパターンの周辺分の露出している金表面を金エッチャント（ヨウ化カリウム：ヨウ素：水＝6：1：80）により金をエッチングした。超純水で洗浄した後、金のエッチングにより露出したクロムをクロムエッチャント（10%硝酸二セリウムアンモニウム（IV））によりエッチングを行い、超純水で洗浄した。
- 5) アセトンにつけ、レジストを溶解後、超純水で洗浄し、さらに残っているレジストを完全に除去するために、ピラニア溶液（硫酸：過酸化水素＝1：1）に10分間つけ、超純水で洗浄した。この段階で、フォトマスク通りに円と正方形の金パターンを有するガラス基板が作製された。
- 6) 次に露出しているガラス表面をエッチングするために、上記の金パターンガラス基板を4.6% フッ化水素酸に50分間浸漬した。これにより、ガラス表面は、約50 μmの深さ分だけ腐食され、またアンダーカットにより金パターンの下も横方向から侵食され、直径約200 μmの円と1辺約200 μmの正方形のパターンは、約90 μm（直径又は1辺）のパターンとなった。
- 7) 4)と同様に、金とクロムのエッチングを行った後、ピラニア溶液、超純水で基板を洗浄した。
- 8) 1)と同様に、クロムと金を蒸着し、金が表面に蒸着された核酸マイクロアレイ用基板を作製した（図8）。

【0056】

図8 a) は、実施例1で作製された基板をデジタルカメラにて撮影したものである。凹凸が形成されていることが像からわかる。図8 b) は、正方形のスポットについて、共焦点顕微鏡により光学切片を撮像し、3次元構築したものである。基板上に、頂上にスポット用平面を有する突出スポット部が形成されていることがわかる。正方形のスポットの高さは、約50 μm の高さを有していた。実施例1で得られた基板上のスポット用平面の大きさは、90 μm であり、突出スポット部周辺の基板表面と、突出スポット部側面とのなす角は、110度であった。

【0057】

実施例2

核酸マイクロアレイ用基板へのDNAスタンピング

5'-蛍光色素Cy3を標識したDNA溶液 (tatgacaatg aatacggcta cagcaacagg gtggtggacc tcatg (配列番号1) (遺伝子名GAPDH) 溶液組成: 50 μM in 1×マイクロスポッティング溶液 (テレケム社)) を、理研で開発したDNAアレイヤーにより、実施例1で作製した核酸マイクロアレイ用基板の突出スポット部頂上のスポット用平面へスタンプした。スタンプ針の先端は、直径130 μm の円形であった。図7に示す蛍光と反射光とを同時に計測することができるDNAマイクロアレイスキャナーによって、DNA溶液をスタンプした基板からの蛍光および反射光の計測を行った (図9)。(a)が蛍光像、(b)が反射光像、(c)が二つの画像の重ね合わせである。ここで使用したDNAマイクロアレイスキャナーでは、蛍光像は赤色で、反射像は緑色で表示される。円形のスポットでは、赤色で表示された円形の蛍光像が観察でき、また、正方形のスポットでは、赤色で表示された正方形の蛍光像が観察できた。また、これらの蛍光像を、緑色で表示された反射像と重ね合わせたところ、蛍光像のスポットの形と一致したことから、DNAスタンプ溶液が、基板上の突出スポット部頂上のスポット用平面のみにスタンピングされたことが証明された。このように、本発明の基板によれば、反射像により、基板上の突出スポット部頂上のスポット用平面の位置および大きさを認識し、DNAがスタンプされた領域を特定することができる。

。なお、本実施例で使用したスキャナーの反射用の焦点深度は $500\mu\text{m}$ であったため、突出スポット部周辺の基板表面（突出スポット部頂上のスポット平面との高低差： $50\mu\text{m}$ ）からの反射光も、スポット平面からの反射光とはほぼ同様の強度で検出された。但し、本実施例では、突出スポット部周辺の基板表面と、突出スポット部側面とのなす角が、 110 度であったため、反射像で、側面部に相当する部分が黒い縁取りとして表れることにより、スポットの位置および大きさを特定することができた。

【0058】

実施例 3

電気泳動によるハイブリダイゼーションの促進効果の検証（直流電荷）

実施例 1 で得られた核酸マイクロアレイ用基板の突出スポット部頂上のスポット用平面に、チオール化 DNA プローブ（tatgacaatg aatacggcta cagcaacagg gtggtggacc tcatg（配列番号 2）、遺伝子名 GAPDH）を固定化し、蛍光標識マウス脳 cRNA をターゲットとしてハイブリダイゼーションを行った。

DNA マイクロアレイと ITO 電極を向かい合うようにし、その間に絶縁のために 0.17mm のガラスをはさみ、基板と電極とをクリップにより固定した。 0.17mm の空間に上記ターゲットを含有するハイブリダイゼーション溶液（cRNA： $1.45\mu\text{g}$ （mRNA $0.05\mu\text{g}$ に相当）、ハイブリダイゼーションバッファー： 50mM ヒスチジン）を入れ、DNA マイクロアレイ側には、プラス電極をつなぎ、ITO 電極には、マイナス電極をつなぎ、室温で、 3V の直流電荷を 2 分間かけた。その後、 $2\times\text{SSC}+0.1\%\text{SDS}$ 、 $1\times\text{SSC}$ （ 150mM 塩化ナトリウム、 15mM クエン酸ナトリウム）、 $0.1\times\text{SSC}$ で洗浄を行った。

図 7 に示す蛍光と反射光とを同時に計測することができる DNA マイクロアレイスキャナーによって、このマイクロアレイを観察した結果、図 10 に示すように、電荷をかけたもの（c）では、電荷をかけなかったもの（b）に比べ明らかに高い蛍光シグナルが得られ、電気泳動により、ハイブリダイゼーションの促進効果があることが明らかとなった。またこの蛍光像を、反射像（a）と重ね合わ

せれば、ハイブリダイゼーションの生じたスポットを特定することができる。

【0059】

実施例 4

誘電泳動によるハイブリダイゼーションの促進効果の検証（交流電荷）

実施例 1 で得られた核酸マイクロレイ用基板の突出スポット部頂上のスポット用平面に、5 種類の DNA プローブ（配列番号 3 : ggccgttctgcttacagtggcttgacagcagctcctacttgatg・遺伝子名 NFL、配列番号 4 : gtaccaacattgcctcctagcagagaa gtgtgtgtgtgagaagcc・遺伝子名 Ubiquitin2e、配列番号 5 : ttttgtcccccaacttgatgtatgaaggctttggtctccctggg 遺伝子名 β -actin、配列番号 6 : gcagtggcaaagtgg agattgttgccatcaacgacccttcattg 遺伝子名 gapdh、配列番号 7 : agccaggaaattgtcgagagcgcagccacttctttcagtgttg 遺伝子名 psbP）を末端固定し、5' 蛍光 Cy3 標識した各相補オリゴ DNA をターゲットとしてハイブリダイゼーションを行った。ハイブリダイゼーション溶液は 50mM スズンとし、各相補鎖オリゴ DNA の最終ターゲット濃度を、配列番号 3 の DNA プローブについては 0.001 μ M、配列番号 4 の DNA プローブについては 0.01 μ M、配列番号 5 の DNA プローブについては 0.1 μ M、配列番号 6 の DNA プローブについては 1 μ M、配列番号 7 の DNA プローブについては 0 μ M（無添加）として調製混合した。マイクロレイと対向金電極を向かい合うようにし、その間に絶縁のために 0.03mm のゴムシートをはさみ、マイクロレイと電極とをクリップにより固定した。0.03mm の空間に上記ターゲットを有するハイブリダイゼーション溶液を入れ、マイクロレイと対向金電極とを、電源・発振器につなぎ、1MHz、0.2MV/m の交流電荷を 2 分間かけた。図 7 に示す蛍光と反射光とを同時に計測することができる DNA マイクロレイスキャナーによって、このマイクロレイを観察した結果、図 11 に示すように、電荷をかけたもの（a）では、電荷をかけなかったもの（b）に比べ明らかに高い蛍光シグナルが得られた。ターゲット濃度と蛍光強度との相関を、図 12 に示す。図 11 および図 12 より、マイクロレイと対向電極との間に交流電荷を印加することによって、誘電泳動によるハイブリダイゼーションの促進効果が得られることがわかる。また、本実施例で、ターゲット濃度に依存した蛍光シグナルが得られていること、および、ネガティブコントロールでシグナルが検出されな

かったことから、蛍光強度により、ハイブリダイゼーションの程度を測定することができることがわかる。また、図11(a)の蛍光像を、図11(c)の反射像と重ね合わせれば、ハイブリダイゼーションの生じたスポットを特定することができる。

【0060】

【発明の効果】

本発明によれば、生体分子マイクロアレイに一定形状の生体分子固定化領域を持つ基板及び生体分子の相互作用、特にハイブリダイゼーションを高速に行い、かつ微量サンプルの相互作用を促進させ、さらに高速・高感度に相互作用を検出し解析する手段を提供することができる。

【配列表】

SEQUENCE LISTING

<110> RIKEN

<120> Substrate for biomolecule microarray, biomolecule microarray, device and method for accelerating interaction and detecting method of interaction

<130> A35048H

<160> 7

<210> 1

<211> 45

<212> DNA

<213> GAPDH

<400> 1

tatgacaatg aatacggcta cagcaacagg gtggtggacc tcatg 45

<210> 2

<211> 45

<212> DNA

<213> GAPDH

<400> 2

tatgacaatg aatacggcta cagcaacagg gtggtggacc tcatg 45

<210> 3

<211> 45

<212> DNA

<213> NFL

<400> 3

ggccgttctg cttacagtgg cttgcagagc agctcctact tgatg 45

<210> 4

<211> 45

<212> DNA

<213> Ubiquitin2e

<400> 4

gtaccaacat tgcctcctag cagagaagtg tgtgtgtgag aagcc 45

<210> 5

<211> 45

<212> DNA

<213> β -actin

<400> 5

ttttgtcccc ccaacttgat gtatgaaggc tttggtctcc ctggg 45

<210> 6

<211> 45

<212> DNA

<213> gapdh

<400> 6

gcagtggcaa agtggagatt gttgcatca acgaccctt cattg 45

<210> 7

<211> 45

<212> DNA



<213> psbP

<400> 7

agccaggaaa ttgtcgaga gcgcagccac ttcttttcagt gttgc 45

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明で使用する共焦点型検出器の光学系の概略図である。

【図 2】 本発明の基板上の突出スポット部の概略図である。

【図 3】 本発明の基板の粗面化されたスポット用平面の一例（部分拡大図）を示す。

【図 4】 略 V 字型底面を有する基板の一部の拡大図を示す。

【図 5】 本発明の第二の態様の基板の一例を示す。

【図 6】 本発明の生体分子の相互作用促進用装置の概略図を示す。

【図 7】 反射光と蛍光とを同時に検出することができる共焦点型スキャナーの光学系の概略図を示す。

【図 8】 実施例 1 で作製した基板のデジタルカメラ像および共焦点顕微鏡像である。

【図 9】 実施例 2 で得られた蛍光像（a）、反射像（b）、および、蛍光像と反射像とを重ね合わせた像（c）である。

【図 10】 実施例 3 で得られた反射像および蛍光像である。

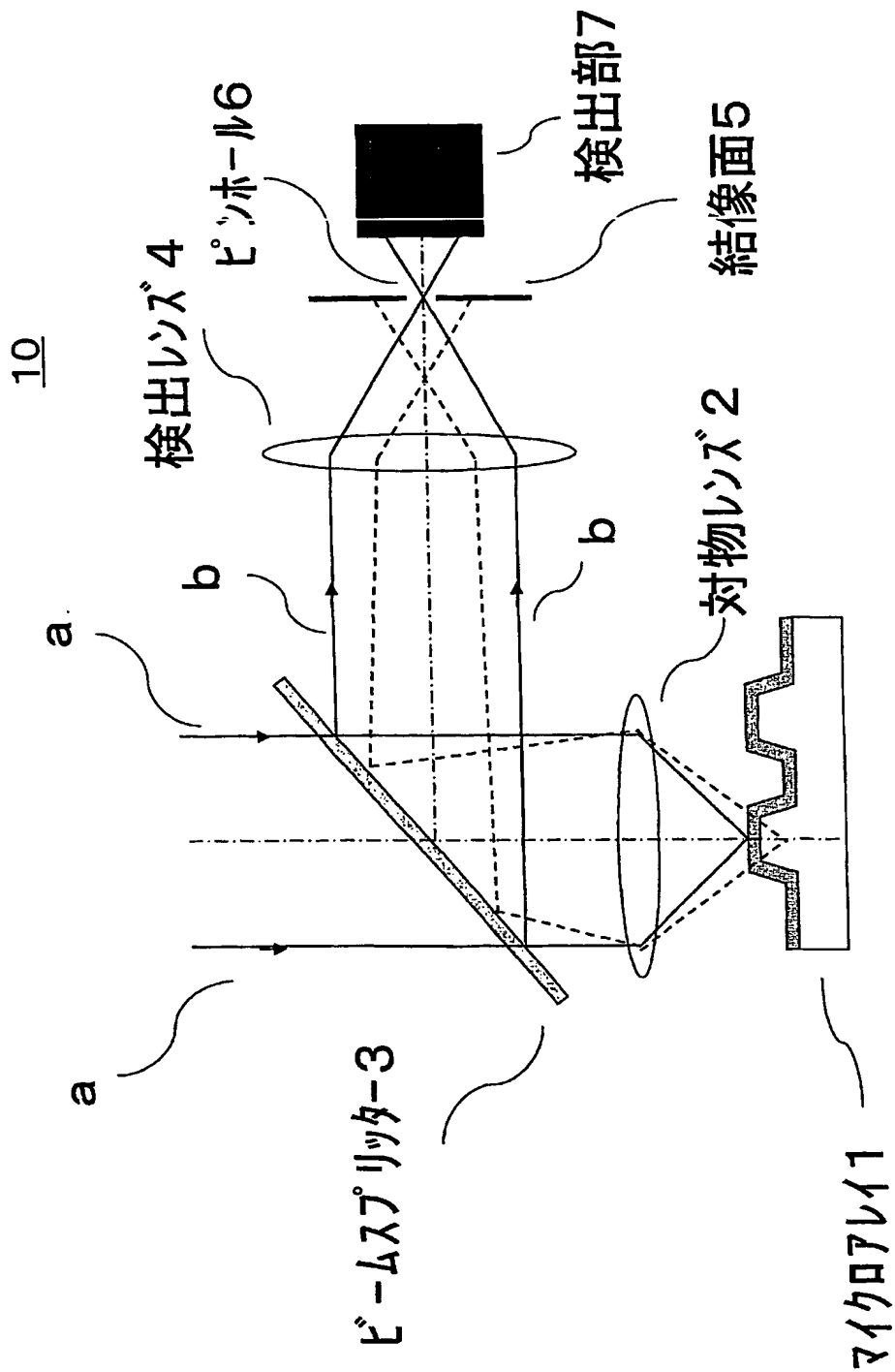
【図 11】 実施例 4 で得られた反射像および蛍光像である。

【図 12】 実施例 4 におけるターゲット濃度と蛍光強度との相関を示すグラフである。

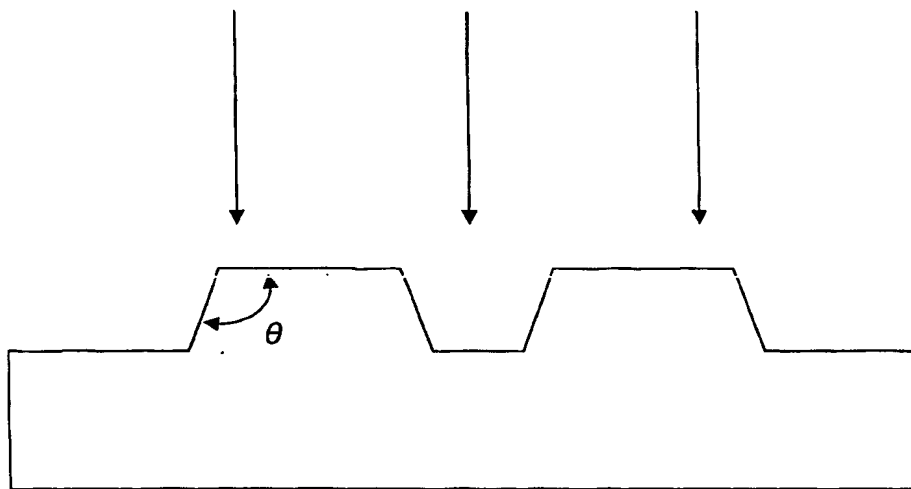
【書類名】

図面

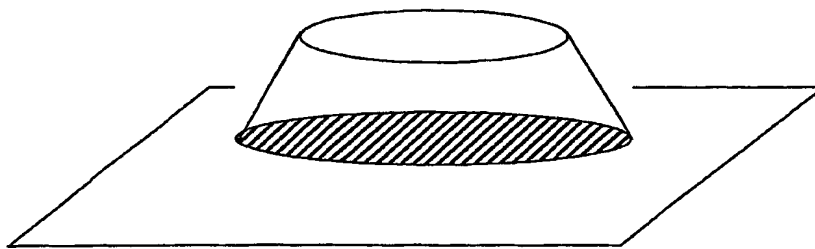
【図 1】



【図 2】

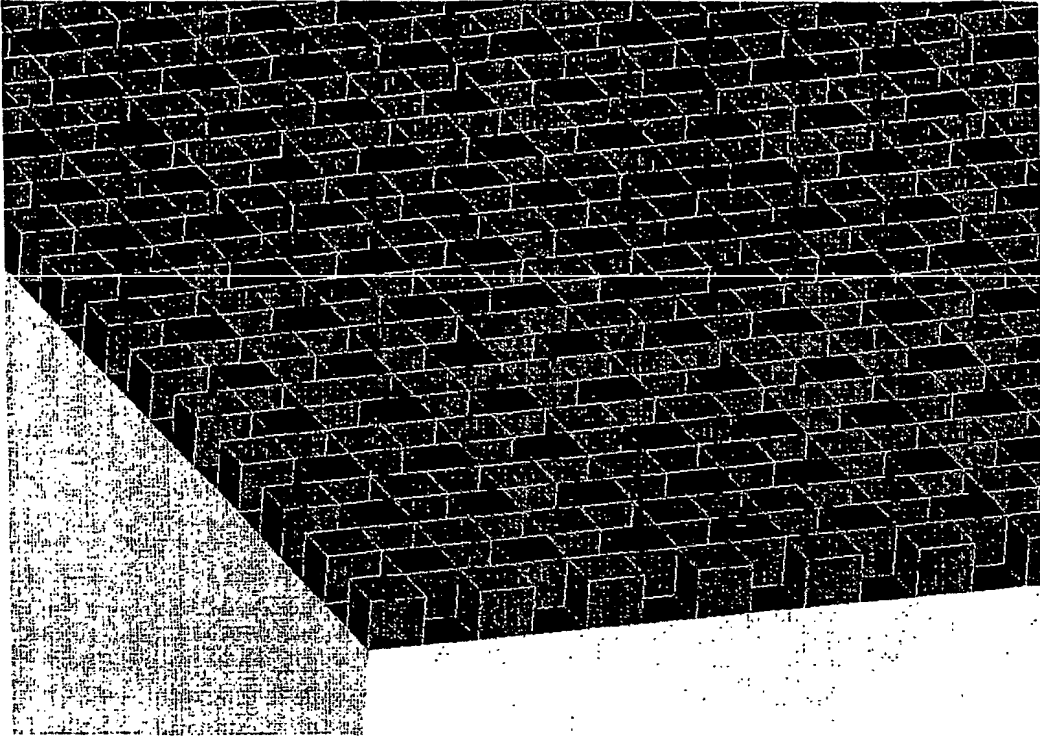


(a)

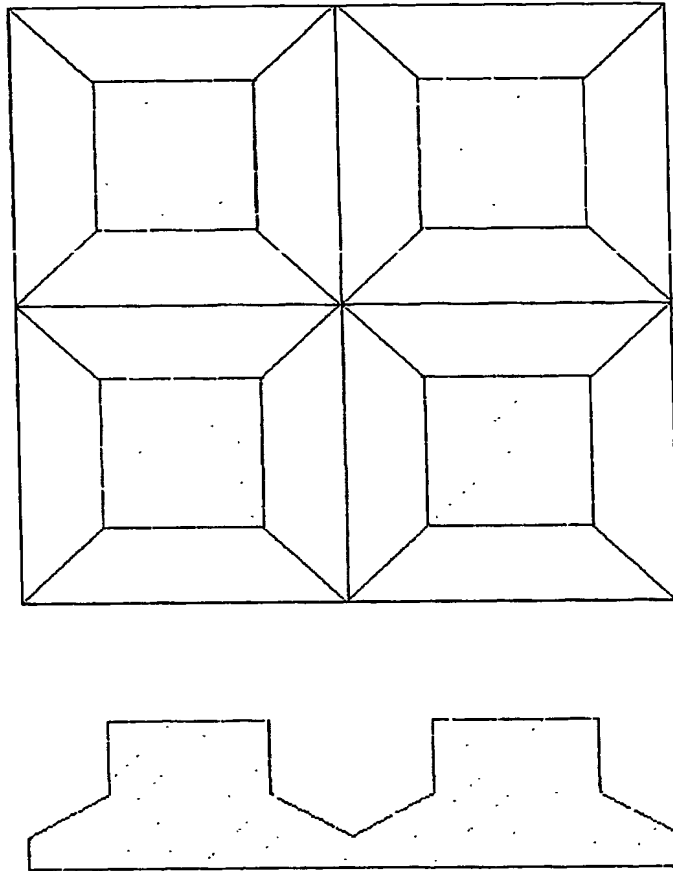


(b)

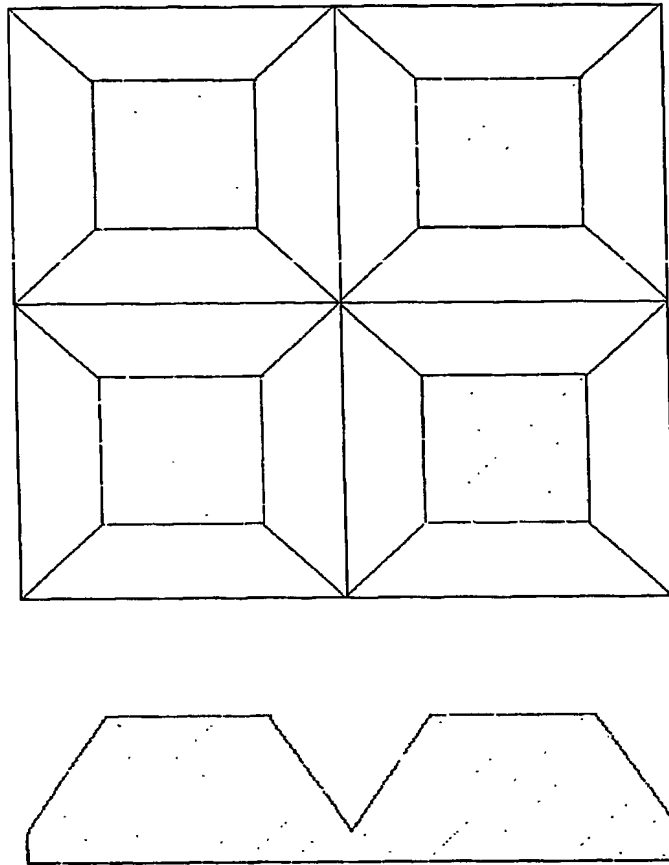
【図 3】



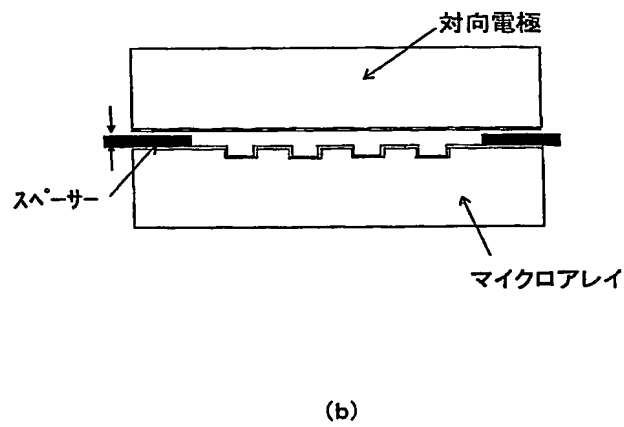
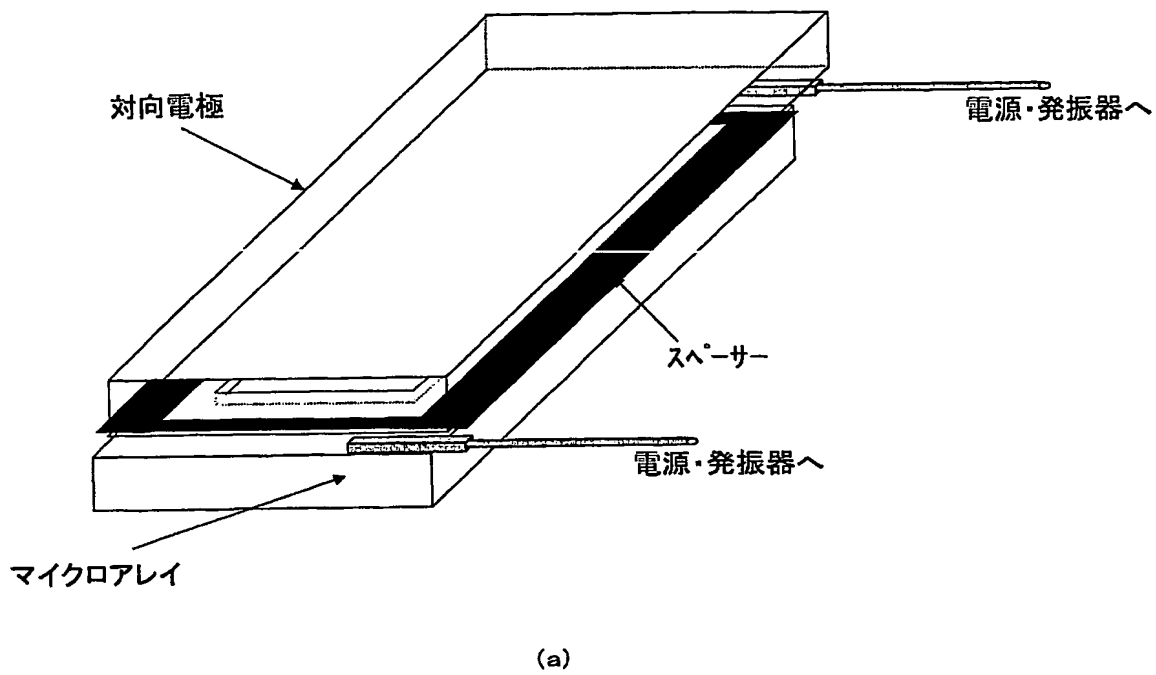
【図 4】



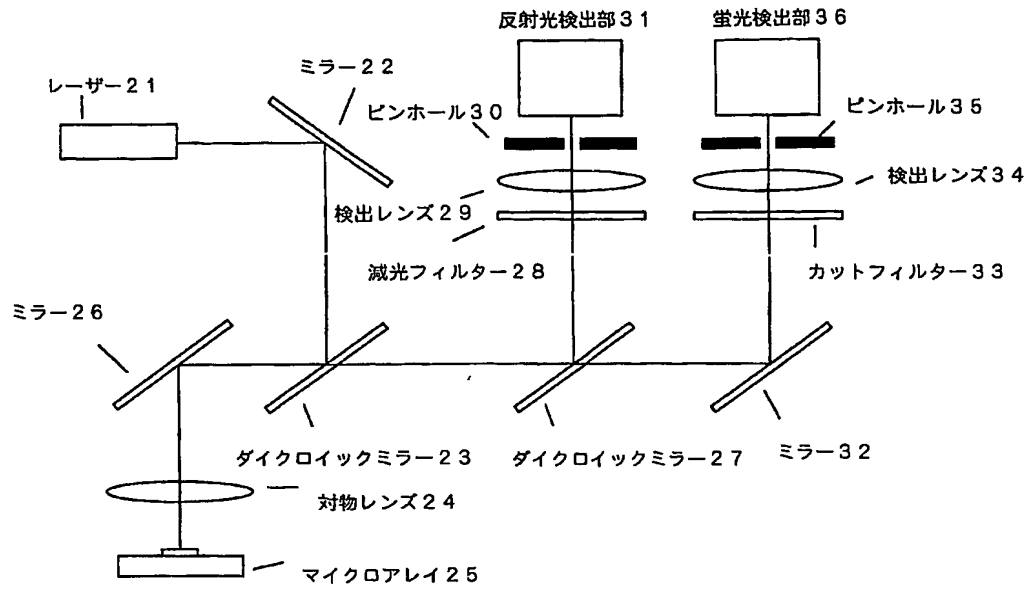
【図5】



【図 6】

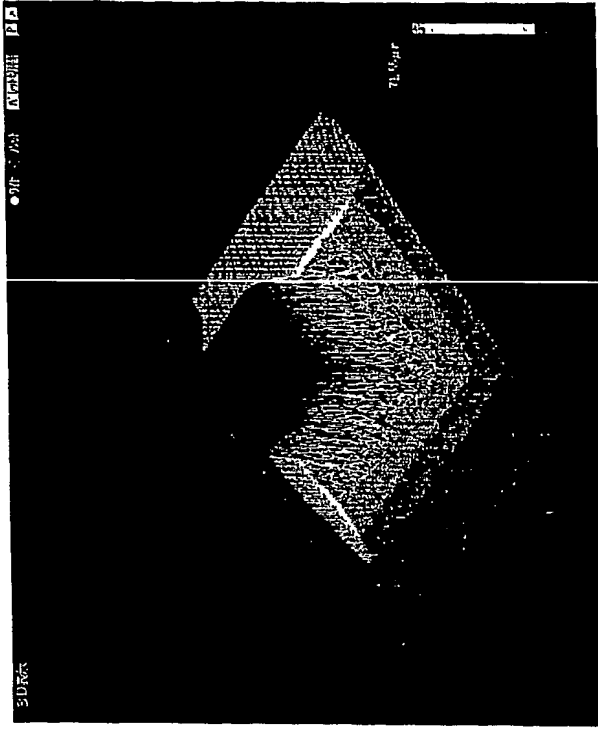


【図 7】



【図 8】

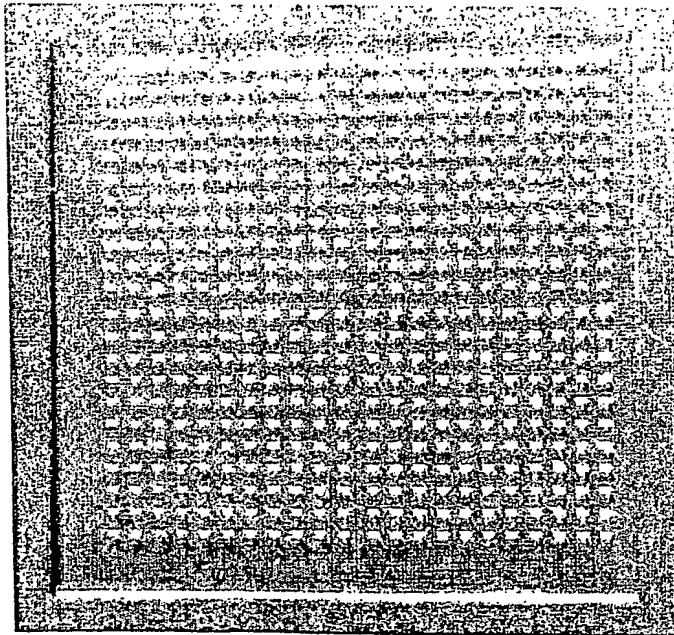
b) 正方形スポットの共焦点顕微鏡像 (拡大像)



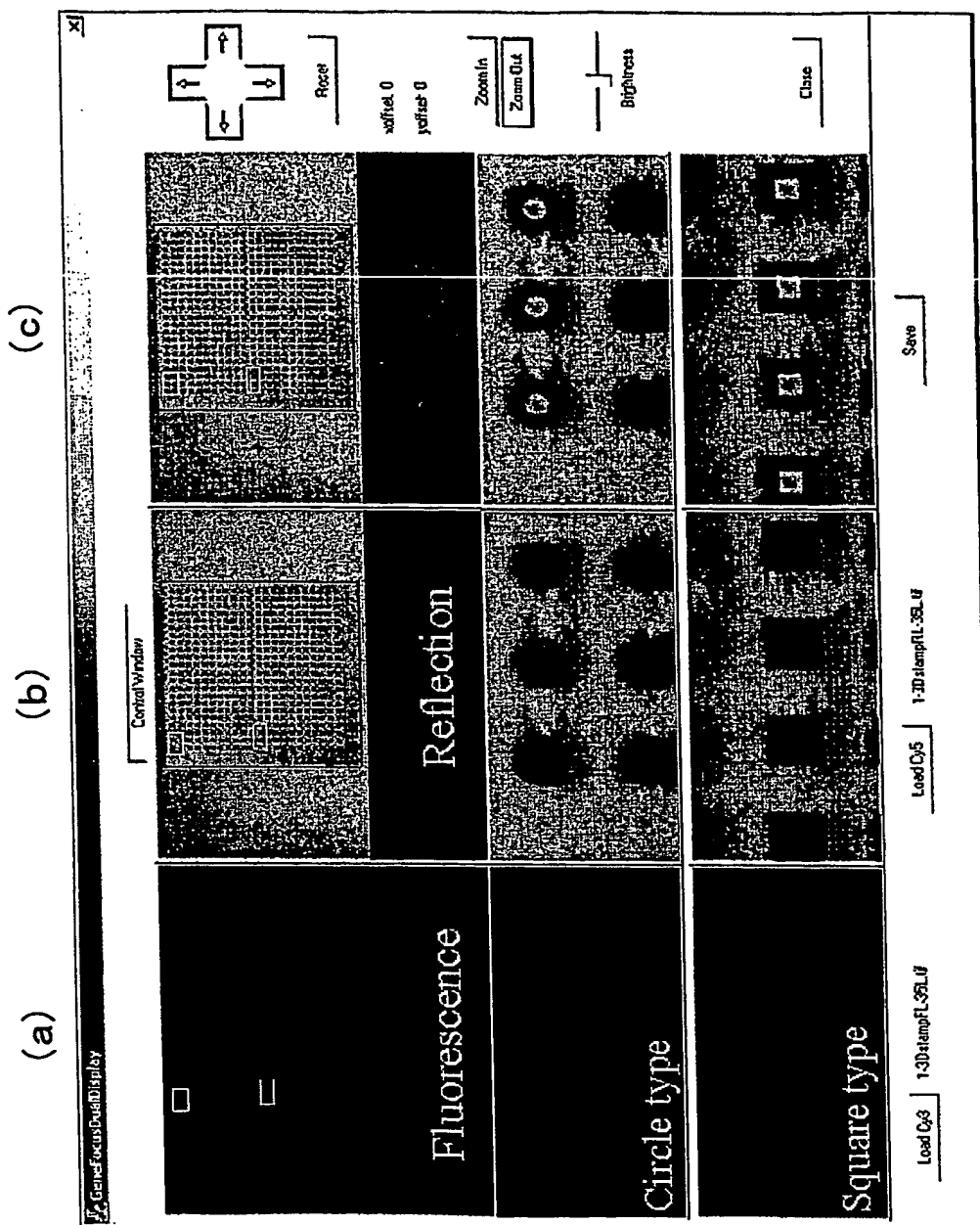
溝部分

凸部スポット

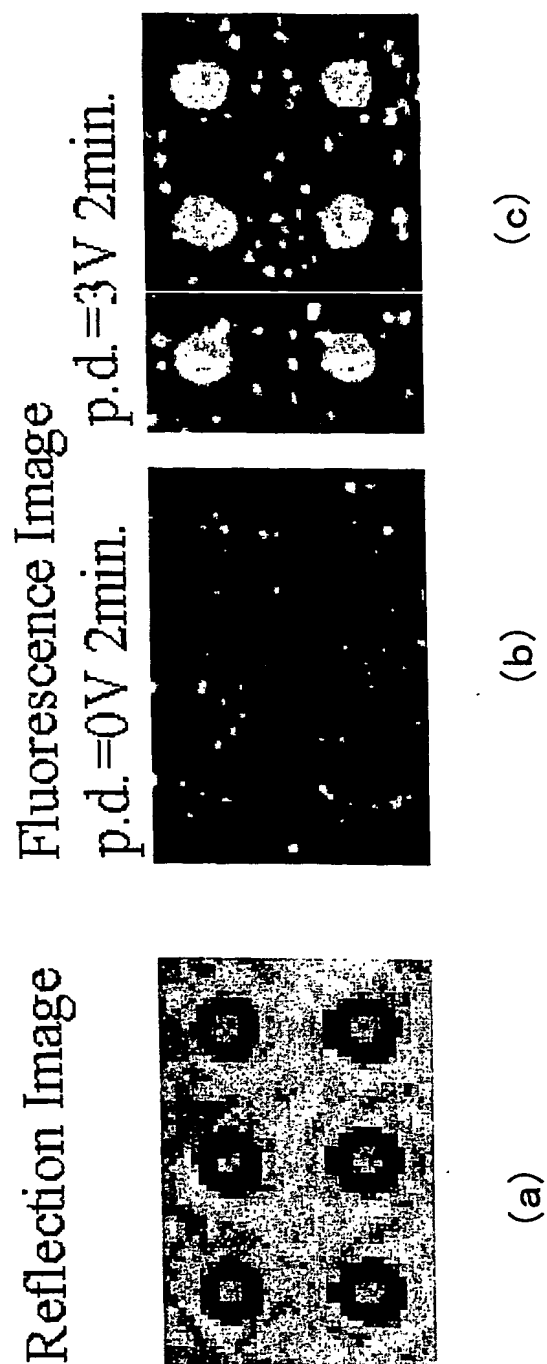
a) 基板全体のデジタルカメラ像



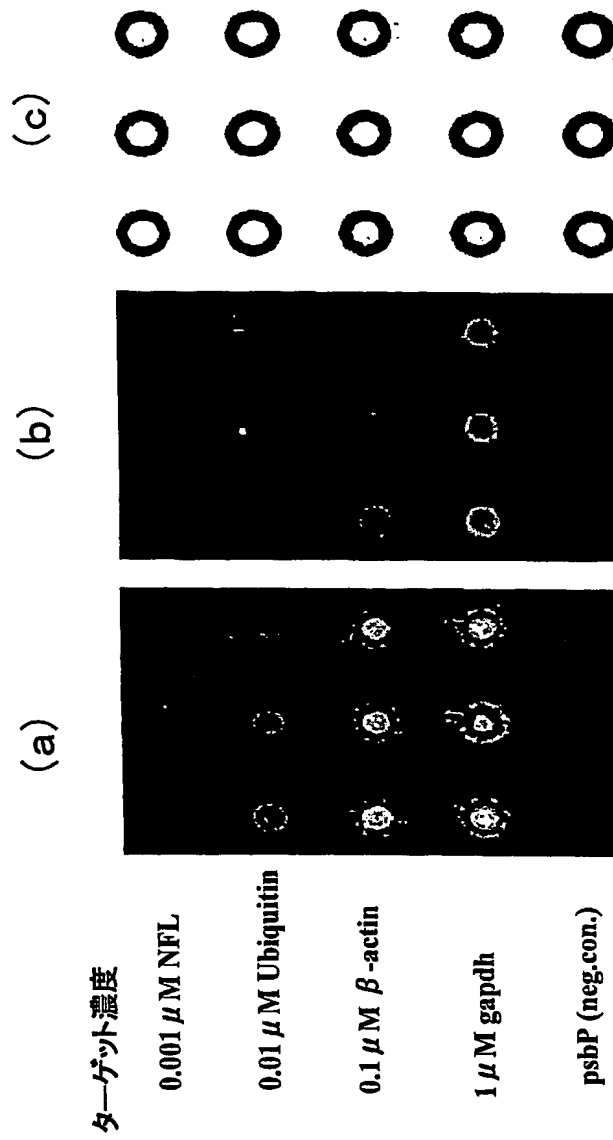
【図 9】



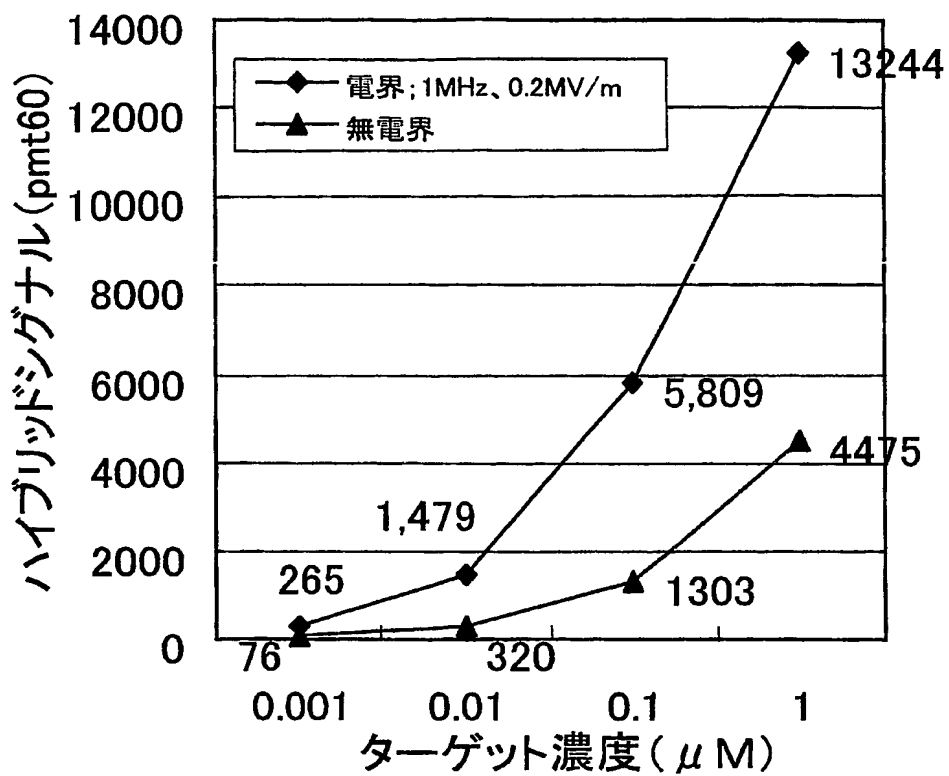
【図 10】



【図11】



【図 12】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 生体分子マイクロアレイに一定形状の生体分子固定化領域をもつ基板及び生体分子の相互作用を高速に行い、かつ微量サンプルの相互作用を促進させ、さらに高速・高感度に相互作用を検出し解析する手段を提供すること。

【解決手段】 基板表面に、生体分子固定化用スポットを1つ以上有する生体分子マイクロアレイ用基板。前記生体分子固定化用スポットは、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有し、かつ少なくとも、前記突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側面、およびスポット用平面は、導電性物質からなるか、または、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有し、隣り合う突出スポット部は、突出スポット部側面によって隣接しており、かつ少なくとも、前記突出スポット部側面およびスポット用平面は、導電性物質からなる。前記基板および生体分子を含み、生体分子は、前記基板上の少なくともスポット用平面に固定化されている生体分子マイクロアレイ。基板上に1つ以上の生体分子固定化スポットを有する生体分子マイクロアレイ、前記マイクロアレイの生体分子固定化スポットを有する面に対向するように設けられた電極、および前記マイクロアレイと前記電極との間に電界を印加するための電源を有する生体分子の相互作用促進用装置。前記装置を用いる生体分子の相互作用促進方法。生体分子相互作用の検出方法。

【選択図】 なし

【書類名】 出願人名義変更届 (一般承継)
【提出日】 平成15年12月 1日
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願2003-170051
【承継人】
【識別番号】 503359821
【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢 2 番 1 号
【氏名又は名称】 独立行政法人理化学研究所
【承継人代理人】
【識別番号】 100075812
【弁理士】
【氏名又は名称】 吉武 賢次
【提出物件の目録】
【物件名】 権利の承継を証明する書面 1
【援用の表示】 平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件
にかか一般承継による特許権の移転登録申請書
【物件名】 登記簿謄本 1
【援用の表示】 平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件
にかか一般承継による特許権の移転登録申請書
【物件名】 委任状 1

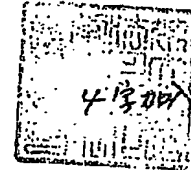
【物件名】

委任状

【添付書類】 325



委 任 状



私は、

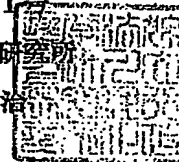
識別番号 100075812 弁理士 吉 武 賢 次 氏
を代理人と定めて下記事項を委任する。

1. 別紙目録に記載の特許出願に関する出願人名義変更届をする件
954件
2. 上記各項の手続を処理するため復代理人を選任及び解任する件

以 上

平成 / 5 年 / 1 月 / 3 日

住所又は居所 埼玉県和光市広沢2番1号
氏名又は名称 独立行政法人 理化学研究所
代 表 者 理事長 野 依 良 治



目 録 (1)

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. 特願昭63-235737 | 51. 特願平07-327372 |
| 2. 特願平05-044143 | 52. 特願平08-000652 |
| 3. 特願平05-127257 | 53. 特願平08-026368 |
| 4. 特願平05-127258 | 54. 特願平08-030850 |
| 5. 特願平05-213675 | 55. 特願平08-041279 |
| 6. 特願平05-306164 | 56. 特願平08-045903 |
| 7. 特願平05-328611 | 57. 特願平08-051604 |
| 8. 特願平05-336746 | 58. 特願平08-065715 |
| 9. 特願平05-035100 | 59. 特願平08-070071 |
| 10. 特願平06-061792 | 60. 特願平08-105667 |
| 11. 特願平06-061793 | 61. 特願平08-107784 |
| 12. 特願平06-069150 | 62. 特願平08-116473 |
| 13. 特願平06-097098 | 63. 特願平08-123475 |
| 14. 特願平06-111624 | 64. 特願平08-127005 |
| 15. 特願平06-121100 | 65. 特願平08-131746 |
| 16. 特願平06-145908 | 66. 特願平08-132846 |
| 17. 特願平06-158670 | 67. 特願平08-132854 |
| 18. 特願平06-158671 | 68. 特願平08-142676 |
| 19. 特願平06-165751 | 69. 特願平08-158078 |
| 20. 特願平06-165752 | 70. 特願平08-167401 |
| 21. 特願平06-181857 | 71. 特願平08-196331 |
| 22. 特願平06-235742 | 72. 特願平08-197050 |
| 23. 特願平06-238603 | 73. 特願平08-197051 |
| 24. 特願平06-244764 | 74. 特願平08-211946 |
| 25. 特願平06-248486 | 75. 特願平08-216506 |
| 26. 特願平06-252942 | 76. 特願平08-216508 |
| 27. 特願平06-268723 | 77. 特願平08-222352 |
| 28. 特願平06-293933 | 78. 特願平08-231066 |
| 29. 特願平06-301372 | 79. 特願平08-233442 |
| 30. 特願平06-323795 | 80. 特願平08-236685 |
| 31. 特願平06-324490 | 81. 特願平08-251410 |
| 32. 特願平06-507966 (特願2002-12420) | 82. 特願平08-262051 |
| 33. 特願平07-007185 | 83. 特願平08-302896 |
| 34. 特願平07-069255 | 84. 特願平08-308335 |
| 35. 特願平07-082880 | 85. 特願平08-308336 |
| 36. 特願平07-083142 | 86. 特願平08-311467 |
| 37. 特願平07-117933 | 87. 特願平08-315093 |
| 38. 特願平07-133487 | 88. 特願平08-317622 |
| 39. 特願平07-205141 | 89. 特願平08-320241 |
| 40. 特願平07-214659 | 90. 特願平08-506395 |
| 41. 特願平07-217276 | 91. 特願平09-002295 |
| 42. 特願平07-236185 | 92. 特願平09-010602 |
| 43. 特願平07-240684 | 93. 特願平09-019968 |
| 44. 特願平07-249244 | 94. 特願平09-019969 |
| 45. 特願平07-259922 | 95. 特願平09-019971 |
| 46. 特願平07-282716 | 96. 特願平09-024890 |
| 47. 特願平07-302793 | 97. 特願平09-028982 |
| 48. 特願平07-306004 | 98. 特願平09-046824 |
| 49. 特願平07-311711 | 99. 特願平09-049254 |
| 50. 特願平07-311715 | 100. 特願平09-053478 |

目録(2)

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 101. 特願平09-054595 | 151. 特願平10-045434 |
| 102. 特願平09-056654 | 152. 特願平10-049499 |
| 103. 特願平09-057342 | 153. 特願平10-049867 |
| 104. 特願平09-058774 | 154. 特願平10-051489 |
| 105. 特願平09-067611 | 155. 特願平10-051490 |
| 106. 特願平09-074394 | 156. 特願平10-051491 |
| 107. 特願平09-080480 | 157. 特願平10-051492 |
| 108. 特願平09-082965 | 158. 特願平10-051493 |
| 109. 特願平09-091523 | 159. 特願平10-060740 |
| 110. 特願平09-091591 | 160. 特願平10-060741 |
| 111. 特願平09-091694 | 161. 特願平10-061895 |
| 112. 特願平09-096968 | 162. 特願平10-076139 |
| 113. 特願平09-099061 | 163. 特願平10-085207 |
| 114. 特願平09-099109 | 164. 特願平10-085208 |
| 115. 特願平09-104093 | 165. 特願平10-103083 |
| 116. 特願平09-119730 | 166. 特願平10-103115 |
| 117. 特願平09-129068 | 167. 特願平10-103671 |
| 118. 特願平09-134525 | 168. 特願平10-104093 |
| 119. 特願平09-147964 | 169. 特願平10-113493 |
| 120. 特願平09-155364 | 170. 特願平10-116378 |
| 121. 特願平09-159963 | 171. 特願平10-121456 |
| 122. 特願平09-163630 | 172. 特願平10-127520 |
| 123. 特願平09-163631 | 173. 特願平10-136198 |
| 124. 特願平09-171924 | 174. 特願平10-149603 |
| 125. 特願平09-175896 | 175. 特願平10-150494 |
| 126. 特願平09-180423 | 176. 特願平10-151245 |
| 127. 特願平09-189436 | 177. 特願平10-155838 |
| 128. 特願平09-198201 | 178. 特願平10-155841 |
| 129. 特願平09-208866 | 179. 特願平10-156104 |
| 130. 特願平09-221067 | 180. 特願平10-156108 |
| 131. 特願平09-228345 | 181. 特願平10-198313 |
| 132. 特願平09-230870 | 182. 特願平10-200280 |
| 133. 特願平09-253740 | 183. 特願平10-217132 |
| 134. 特願平09-256795 | 184. 特願平10-217180 |
| 135. 特願平09-271782 | 185. 特願平10-222837 |
| 136. 特願平09-291995 | 186. 特願平10-227939 |
| 137. 特願平09-297084 | 187. 特願平10-229591 |
| 138. 特願平09-307627 | 188. 特願平10-232520 |
| 139. 特願平09-308597 | 189. 特願平10-232590 |
| 140. 特願平09-309848 | 190. 特願平10-236009 |
| 141. 特願平09-327140 | 191. 特願平10-237485 |
| 142. 特願平09-327609 | 192. 特願平10-238144 |
| 143. 特願平09-328742 | 193. 特願平10-245293 |
| 144. 特願平09-360327 | 194. 特願平10-250598 |
| 145. 特願平10-002030 | 195. 特願平10-250611 |
| 146. 特願平10-010471 | 196. 特願平10-252128 |
| 147. 特願平10-014152 | 197. 特願平10-260347 |
| 148. 特願平10-015690 | 198. 特願平10-260416 |
| 149. 特願平10-024892 | 199. 特願平10-268791 |
| 150. 特願平10-043335 | 200. 特願平10-269859 |

目 録 (3)

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 201. 特願平 10-272529 | 251. 特願平 11-135137 |
| 202. 特願平 10-280351 | 252. 特願平 11-135482 |
| 203. 特願平 10-308533 | 253. 特願平 11-143429 |
| 204. 特願平 10-309765 | 254. 特願平 11-144005 |
| 205. 特願平 10-311673 | 255. 特願平 11-147097 |
| 206. 特願平 10-311674 | 256. 特願平 11-151099 |
| 207. 特願平 10-311675 | 257. 特願平 11-166247 |
| 208. 特願平 10-314856 | 258. 特願平 11-173839 |
| 209. 特願平 10-315751 | 259. 特願平 11-179278 |
| 210. 特願平 10-338896 | 260. 特願平 11-186052 |
| 211. 特願平 10-338897 | 261. 特願平 11-193235 |
| 212. 特願平 10-338898 | 262. 特願平 11-224269 |
| 213. 特願平 10-338899 | 263. 特願平 11-225060 |
| 214. 特願平 10-352428 | 264. 特願平 11-225832 |
| 215. 特願平 10-354665 | 265. 特願平 11-225839 |
| 216. 特願平 10-363297 | 266. 特願平 11-226176 |
| 217. 特願平 10-363329 | 267. 特願平 11-234800 |
| 218. 特願平 10-506788 | 268. 特願平 11-240325 |
| 219. 特願平 10-532832 | 269. 特願平 11-240910 |
| 220. 特願平 10-535583 | 270. 特願平 11-241737 |
| 221. 特願平 11-008183 | 271. 特願平 11-242438 |
| 222. 特願平 11-013380 | 272. 特願平 11-242490 |
| 223. 特願平 11-015176 | 273. 特願平 11-253851 |
| 224. 特願平 11-031724 | 274. 特願平 11-260947 |
| 225. 特願平 11-035776 | 275. 特願平 11-277759 |
| 226. 特願平 11-046372 | 276. 特願平 11-278976 |
| 227. 特願平 11-055835 | 277. 特願平 11-279324 |
| 228. 特願平 11-055867 | 278. 特願平 11-281632 |
| 229. 特願平 11-055930 | 279. 特願平 11-303976 |
| 230. 特願平 11-056957 | 280. 特願平 11-309616 |
| 231. 特願平 11-057381 | 281. 特願平 11-315036 |
| 232. 特願平 11-057749 | 282. 特願平 11-321282 |
| 233. 特願平 11-058103 | 283. 特願平 11-336079 |
| 234. 特願平 11-061079 | 284. 特願平 11-346467 |
| 235. 特願平 11-061080 | 285. 特願平 11-354563 |
| 236. 特願平 11-064193 | 286. 特願平 11-360274 |
| 237. 特願平 11-064372 | 287. 特願平 11-365899 |
| 238. 特願平 11-064506 | 288. 特願平 11-373483 |
| 239. 特願平 11-065136 | 289. 特願平 11-510791 |
| 240. 特願平 11-074385 | 290. 特願平 11-515324 |
| 241. 特願平 11-081225 | 291. 特願 2000-001783 |
| 242. 特願平 11-090383 | 292. 特願 2000-005221 |
| 243. 特願平 11-091875 | 293. 特願 2000-009363 |
| 244. 特願平 11-103231 | 294. 特願 2000-010516 |
| 245. 特願平 11-104509 | 295. 特願 2000-011147 |
| 246. 特願平 11-106920 | 296. 特願 2000-011623 |
| 247. 特願平 11-124187 | 297. 特願 2000-016518 |
| 248. 特願平 11-130771 | 298. 特願 2000-016622 |
| 249. 特願平 11-130814 | 299. 特願 2000-017112 |
| 250. 特願平 11-130815 | 300. 特願 2000-018612 |

目 録 (4)

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 301. 特願 2000-019195 | 351. 特願 2000-141763 |
| 302. 特願 2000-019528 | 352. 特願 2000-148843 |
| 303. 特願 2000-020067 | 353. 特願 2000-152455 |
| 304. 特願 2000-030321 | 354. 特願 2000-152469 |
| 305. 特願 2000-034109 | 355. 特願 2000-154484 |
| 306. 特願 2000-039082 | 356. 特願 2000-161895 |
| 307. 特願 2000-040355 | 357. 特願 2000-163122 |
| 308. 特願 2000-041927 | 358. 特願 2000-164584 |
| 309. 特願 2000-041929 | 359. 特願 2000-179723 |
| 310. 特願 2000-045318 | 360. 特願 2000-181281 |
| 311. 特願 2000-045855 | 361. 特願 2000-184259 |
| 312. 特願 2000-051488 | 362. 特願 2000-184295 |
| 313. 特願 2000-051650 | 363. 特願 2000-191007 |
| 314. 特願 2000-052040 | 364. 特願 2000-191265 |
| 315. 特願 2000-053707 | 365. 特願 2000-192332 |
| 316. 特願 2000-054949 | 366. 特願 2000-193817 |
| 317. 特願 2000-056093 | 367. 特願 2000-195384 |
| 318. 特願 2000-056879 | 368. 特願 2000-196991 |
| 319. 特願 2000-057564 | 369. 特願 2000-197022 |
| 320. 特願 2000-057565 | 370. 特願 2000-202801 |
| 321. 特願 2000-057566 | 371. 特願 2000-216457 |
| 322. 特願 2000-058133 | 372. 特願 2000-223714 |
| 323. 特願 2000-058282 | 373. 特願 2000-224970 |
| 324. 特願 2000-062316 | 374. 特願 2000-225486 |
| 325. 特願 2000-064142 | 375. 特願 2000-225864 |
| 326. 特願 2000-064209 | 376. 特願 2000-225978 |
| 327. 特願 2000-071119 | 377. 特願 2000-226361 |
| 328. 特願 2000-076122 | 378. 特願 2000-229191 |
| 329. 特願 2000-085874 | 379. 特願 2000-230551 |
| 330. 特願 2000-089078 | 380. 特願 2000-237165 |
| 331. 特願 2000-092693 | 381. 特願 2000-237166 |
| 332. 特願 2000-100395 | 382. 特願 2000-237533 |
| 333. 特願 2000-105139 | 383. 特願 2000-246309 |
| 334. 特願 2000-105917 | 384. 特願 2000-248331 |
| 335. 特願 2000-107180 | 385. 特願 2000-249232 |
| 336. 特願 2000-108409 | 386. 特願 2000-256149 |
| 337. 特願 2000-109638 | 387. 特願 2000-257080 |
| 338. 特願 2000-109954 | 388. 特願 2000-257083 |
| 339. 特願 2000-118361 | 389. 特願 2000-260030 |
| 340. 特願 2000-120874 | 390. 特願 2000-261233 |
| 341. 特願 2000-123634 | 391. 特願 2000-264743 |
| 342. 特願 2000-128431 | 392. 特願 2000-265344 |
| 343. 特願 2000-131049 | 393. 特願 2000-278502 |
| 344. 特願 2000-131050 | 394. 特願 2000-279557 |
| 345. 特願 2000-131745 | 395. 特願 2000-292422 |
| 346. 特願 2000-134427 | 396. 特願 2000-292832 |
| 347. 特願 2000-136551 | 397. 特願 2000-299812 |
| 348. 特願 2000-136572 | 398. 特願 2000-307464 |
| 349. 特願 2000-138977 | 399. 特願 2000-308248 |
| 350. 特願 2000-141566 | 400. 特願 2000-309581 |

目録(5)

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 401. 特願2000-319775 | 451. 特願2001-071435 |
| 402. 特願2000-322056 | 452. 特願2001-072650 |
| 403. 特願2000-333311 | 453. 特願2001-072668 |
| 404. 特願2000-334686 | 454. 特願2001-072963 |
| 405. 特願2000-334969 | 455. 特願2001-073028 |
| 406. 特願2000-343912 | 456. 特願2001-074964 |
| 407. 特願2000-347398 | 457. 特願2001-074965 |
| 408. 特願2000-347865 | 458. 特願2001-077257 |
| 409. 特願2000-358121 | 459. 特願2001-078671 |
| 410. 特願2000-368566 | 460. 特願2001-084173 |
| 411. 特願2000-374626 | 461. 特願2001-089541 |
| 412. 特願2000-375090 | 462. 特願2001-091911 |
| 413. 特願2000-378421 | 463. 特願2001-092337 |
| 414. 特願2000-378942 | 464. 特願2001-116171 |
| 415. 特願2000-378950 | 465. 特願2001-124294 |
| 416. 特願2000-384771 | 466. 特願2001-124452 |
| 417. 特願2000-387016 | 467. 特願2001-127575 |
| 418. 特願2000-394815 | 468. 特願2001-127576 |
| 419. 特願2000-396445 | 469. 特願2001-135357 |
| 420. 特願2000-399940 | 470. 特願2001-137087 |
| 421. 特願2000-400336 | 471. 特願2001-138103 |
| 422. 特願2000-401110 | 472. 特願2001-142583 |
| 423. 特願2000-401245 | 473. 特願2001-147081 |
| 424. 特願2000-401258 | 474. 特願2001-152364 |
| 425. 特願2000-503838 | 475. 特願2001-152379 |
| 426. 特願2000-571733 | 476. 特願2001-153447 |
| 427. 特願2000-571943 | 477. 特願2001-155572 |
| 428. 特願2000-602588 | 478. 特願2001-163740 |
| 429. 特願2000-602900 | 479. 特願2001-164819 |
| 430. 特願2000-618709 | 480. 特願2001-164997 |
| 431. 特願2001-003476 | 481. 特願2001-165133 |
| 432. 特願2001-005615 | 482. 特願2001-167910 |
| 433. 特願2001-007979 | 483. 特願2001-168784 |
| 434. 特願2001-016626 | 484. 特願2001-171705 |
| 435. 特願2001-025030 | 485. 特願2001-173331 |
| 436. 特願2001-037141 | 486. 特願2001-174421 |
| 437. 特願2001-037147 | 487. 特願2001-174553 |
| 438. 特願2001-042501 | 488. 特願2001-175898 |
| 439. 特願2001-044933 | 489. 特願2001-178169 |
| 440. 特願2001-047762 | 490. 特願2001-179858 |
| 441. 特願2001-050645 | 491. 特願2001-180552 |
| 442. 特願2001-053550 | 492. 特願2001-180554 |
| 443. 特願2001-054717 | 493. 特願2001-187735 |
| 444. 特願2001-059115 | 494. 特願2001-197185 |
| 445. 特願2001-059892 | 495. 特願2001-197897 |
| 446. 特願2001-060848 | 496. 特願2001-200854 |
| 447. 特願2001-062703 | 497. 特願2001-201356 |
| 448. 特願2001-065799 | 498. 特願2001-202971 |
| 449. 特願2001-065917 | 499. 特願2001-203089 |
| 450. 特願2001-068285 | 500. 特願2001-206505 |

目録(6)

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 501. 特願2001-206522 | 551. 特願2001-325367 |
| 502. 特願2001-206523 | 552. 特願2001-326872 |
| 503. 特願2001-209305 | 553. 特願2001-327853 |
| 504. 特願2001-212947 | 554. 特願2001-329023 |
| 505. 特願2001-216505 | 555. 特願2001-332168 |
| 506. 特願2001-220219 | 556. 特願2001-337467 |
| 507. 特願2001-226176 | 557. 特願2001-339396 |
| 508. 特願2001-228287 | 558. 特願2001-339593 |
| 509. 特願2001-228374 | 559. 特願2001-346035 |
| 510. 特願2001-235412 | 560. 特願2001-347316 |
| 511. 特願2001-235747 | 561. 特願2001-347637 |
| 512. 特願2001-238951 | 562. 特願2001-349614 |
| 513. 特願2001-241023 | 563. 特願2001-351730 |
| 514. 特願2001-243930 | 564. 特願2001-352189 |
| 515. 特願2001-246642 | 565. 特願2001-353038 |
| 516. 特願2001-249976 | 566. 特願2001-358446 |
| 517. 特願2001-254377 | 567. 特願2001-358581 |
| 518. 特願2001-254378 | 568. 特願2001-359710 |
| 519. 特願2001-255589 | 569. 特願2001-374928 |
| 520. 特願2001-256576 | 570. 特願2001-376591 |
| 521. 特願2001-257188 | 571. 特願2001-378757 |
| 522. 特願2001-261158 | 572. 特願2001-380473 |
| 523. 特願2001-266004 | 573. 特願2001-382537 |
| 524. 特願2001-266069 | 574. 特願2001-382539 |
| 525. 特願2001-266454 | 575. 特願2001-382599 |
| 526. 特願2001-267194 | 576. 特願2001-385258 |
| 527. 特願2001-267379 | 577. 特願2001-385512 |
| 528. 特願2001-267863 | 578. 特願2001-385513 |
| 529. 特願2001-272977 | 579. 特願2001-385538 |
| 530. 特願2001-273964 | 580. 特願2001-388116 |
| 531. 特願2001-276053 | 581. 特願2001-390122 |
| 532. 特願2001-279406 | 582. 特願2001-392087 |
| 533. 特願2001-280319 | 583. 特願2001-392088 |
| 534. 特願2001-285145 | 584. 特願2001-395196 |
| 535. 特願2001-291059 | 585. 特願2001-396120 |
| 536. 特願2001-292223 | 586. 特願2001-397762 |
| 537. 特願2001-292224 | 587. 特願2001-397998 |
| 538. 特願2001-293000 | 588. 特願2001-401139 |
| 539. 特願2001-293054 | 589. 特願2001-515803 |
| 540. 特願2001-293936 | 590. 特願2001-523852 |
| 541. 特願2001-294013 | 591. 特願2001-557672 |
| 542. 特願2001-298140 | 592. 特願2002-000993 |
| 543. 特願2001-298402 | 593. 特願2002-005746 |
| 544. 特願2001-307340 | 594. 特願2002-010344 |
| 545. 特願2001-309501 | 595. 特願2002-011558 |
| 546. 特願2001-309508 | 596. 特願2002-019752 |
| 547. 特願2001-309984 | 597. 特願2002-020329 |
| 548. 特願2001-310554 | 598. 特願2002-022499 |
| 549. 特願2001-313430 | 599. 特願2002-028046 |
| 550. 特願2001-319360 | 600. 特願2002-028109 |

目録(7)

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 601. 特願2002-040151 | 651. 特願2002-162157 |
| 602. 特願2002-042829 | 652. 特願2002-162211 |
| 603. 特願2002-044340 | 653. 特願2002-162365 |
| 604. 特願2002-044640 | 654. 特願2002-167759 |
| 605. 特願2002-046188 | 655. 特願2002-170068 |
| 606. 特願2002-047799 | 656. 特願2002-170902 |
| 607. 特願2002-053190 | 657. 特願2002-176435 |
| 608. 特願2002-053575 | 658. 特願2002-176583 |
| 609. 特願2002-055272 | 659. 特願2002-183722 |
| 610. 特願2002-057253 | 660. 特願2002-185966 |
| 611. 特願2002-057565 | 661. 特願2002-187362 |
| 612. 特願2002-057935 | 662. 特願2002-187957 |
| 613. 特願2002-057963 | 663. 特願2002-188281 |
| 614. 特願2002-066249 | 664. 特願2002-189265 |
| 615. 特願2002-070624 | 665. 特願2002-194627 |
| 616. 特願2002-070987 | 666. 特願2002-197812 |
| 617. 特願2002-071924 | 667. 特願2002-201443 |
| 618. 特願2002-074902 | 668. 特願2002-201575 |
| 619. 特願2002-078164 | 669. 特願2002-202118 |
| 620. 特願2002-081467 | 670. 特願2002-205814 |
| 621. 特願2002-081502 | 671. 特願2002-205825 |
| 622. 特願2002-083081 | 672. 特願2002-217714 |
| 623. 特願2002-084139 | 673. 特願2002-221188 |
| 624. 特願2002-085017 | 674. 特願2002-225469 |
| 625. 特願2002-087342 | 675. 特願2002-225724 |
| 626. 特願2002-094681 | 676. 特願2002-226859 |
| 627. 特願2002-095132 | 677. 特願2002-227286 |
| 628. 特願2002-095389 | 678. 特願2002-229686 |
| 629. 特願2002-100431 | 679. 特願2002-230562 |
| 630. 特願2002-106561 | 680. 特願2002-235294 |
| 631. 特願2002-119320 | 681. 特願2002-235737 |
| 632. 特願2002-120371 | 682. 特願2002-236838 |
| 633. 特願2002-123347 | 683. 特願2002-237058 |
| 634. 特願2002-128854 | 684. 特願2002-237092 |
| 635. 特願2002-133717 | 685. 特願2002-248946 |
| 636. 特願2002-133749 | 686. 特願2002-253322 |
| 637. 特願2002-134313 | 687. 特願2002-253689 |
| 638. 特願2002-141187 | 688. 特願2002-253697 |
| 639. 特願2002-141438 | 689. 特願2002-254096 |
| 640. 特願2002-142260 | 690. 特願2002-257924 |
| 641. 特願2002-149471 | 691. 特願2002-260788 |
| 642. 特願2002-149931 | 692. 特願2002-261499 |
| 643. 特願2002-150541 | 693. 特願2002-264969 |
| 644. 特願2002-154688 | 694. 特願2002-267114 |
| 645. 特願2002-154695 | 695. 特願2002-268987 |
| 646. 特願2002-154823 | 696. 特願2002-270917 |
| 647. 特願2002-158237 | 697. 特願2002-271375 |
| 648. 特願2002-158352 | 698. 特願2002-271473 |
| 649. 特願2002-160277 | 699. 特願2002-273996 |
| 650. 特願2002-162148 | 700. 特願2002-274469 |

目録(8)

701. 特願2002-276051	751. 特願2003-012738
702. 特願2002-282746	752. 特願2003-012774
703. 特願2002-286487	753. 特願2003-015968
704. 特願2002-289209	754. 特願2003-016044
705. 特願2002-295332	755. 特願2003-016940
706. 特願2002-296911	756. 特願2003-017397
707. 特願2002-299429	757. 特願2003-021499
708. 特願2002-301875	758. 特願2003-024347
709. 特願2002-303838	759. 特願2003-024620
710. 特願2002-312131	760. 特願2003-025277
711. 特願2002-320102	761. 特願2003-027647
712. 特願2002-320704	762. 特願2003-027648
713. 特願2002-325909	763. 特願2003-031882
714. 特願2002-325920	764. 特願2003-032932
715. 特願2002-332232	765. 特願2003-038206
716. 特願2002-339344	766. 特願2003-040642
717. 特願2002-339392	767. 特願2003-043961
718. 特願2002-339541	768. 特願2003-050153
719. 特願2002-339551	769. 特願2003-050446
720. 特願2002-341195	770. 特願2003-052520
721. 特願2002-343807	771. 特願2003-052602
722. 特願2002-344279	772. 特願2003-052613
723. 特願2002-345597	773. 特願2003-052877
724. 特願2002-347401	774. 特願2003-053023
725. 特願2002-348760	775. 特願2003-054182
726. 特願2002-349042	776. 特願2003-054798
727. 特願2002-354594	777. 特願2003-054799
728. 特願2002-357768	778. 特願2003-054846
729. 特願2002-357900	779. 特願2003-054847
730. 特願2002-358019	780. 特願2003-054848
731. 特願2002-358967	781. 特願2003-054849
732. 特願2002-360972	782. 特願2003-055452
733. 特願2002-360975	783. 特願2003-056628
734. 特願2002-368112	784. 特願2003-061426
735. 特願2002-376555	785. 特願2003-063532
736. 特願2002-376774	786. 特願2003-065013
737. 特願2002-376831	787. 特願2003-071028
738. 特願2002-379214	788. 特願2003-072979
739. 特願2002-380624	789. 特願2003-074168
740. 特願2002-381888	790. 特願2003-076107
741. 特願2002-382170	791. 特願2003-078999
742. 特願2002-383870	792. 特願2003-079598
743. 特願2002-521644	793. 特願2003-079613
744. 特願2002-532458	794. 特願2003-082466
745. 特願2002-546564	795. 特願2003-083318
746. 特願2002-548185	796. 特願2003-083433
747. 特願2002-570743	797. 特願2003-083480
748. 特願2003-003450	798. 特願2003-085193
749. 特願2003-012550	799. 特願2003-089026
750. 特願2003-012694	800. 特願2003-090331

目 録 (9)

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 801. 特願 2003-091446 | 851. 特願 2003-127135 |
| 802. 特願 2003-092654 | 852. 特願 2003-127150 |
| 803. 特願 2003-093642 | 853. 特願 2003-128818 |
| 804. 特願 2003-094272 | 854. 特願 2003-128897 |
| 805. 特願 2003-094719 | 855. 特願 2003-129347 |
| 806. 特願 2003-095770 | 856. 特願 2003-131313 |
| 807. 特願 2003-095884 | 857. 特願 2003-132280 |
| 808. 特願 2003-095885 | 858. 特願 2003-132605 |
| 809. 特願 2003-095886 | 859. 特願 2003-132606 |
| 810. 特願 2003-095904 | 860. 特願 2003-135591 |
| 811. 特願 2003-097283 | 861. 特願 2003-138445 |
| 812. 特願 2003-097327 | 862. 特願 2003-139397 |
| 813. 特願 2003-101917 | 863. 特願 2003-140684 |
| 814. 特願 2003-104928 | 864. 特願 2003-142303 |
| 815. 特願 2003-105362 | 865. 特願 2003-143932 |
| 816. 特願 2003-107267 | 866. 特願 2003-145221 |
| 817. 特願 2003-107268 | 867. 特願 2003-145390 |
| 818. 特願 2003-107647 | 868. 特願 2003-147820 |
| 819. 特願 2003-107885 | 869. 特願 2003-150690 |
| 820. 特願 2003-109575 | 870. 特願 2003-153014 |
| 821. 特願 2003-115750 | 871. 特願 2003-153015 |
| 822. 特願 2003-115793 | 872. 特願 2003-153016 |
| 823. 特願 2003-115847 | 873. 特願 2003-153985 |
| 824. 特願 2003-115888 | 874. 特願 2003-154009 |
| 825. 特願 2003-116232 | 875. 特願 2003-154841 |
| 826. 特願 2003-116895 | 876. 特願 2003-155397 |
| 827. 特願 2003-118161 | 877. 特願 2003-155407 |
| 828. 特願 2003-118186 | 878. 特願 2003-158017 |
| 829. 特願 2003-119749 | 879. 特願 2003-161005 |
| 830. 特願 2003-119930 | 880. 特願 2003-164126 |
| 831. 特願 2003-120934 | 881. 特願 2003-170051 |
| 832. 特願 2003-121233 | 882. 特願 2003-170324 |
| 833. 特願 2003-121261 | 883. 特願 2003-170325 |
| 834. 特願 2003-121273 | 884. 特願 2003-170326 |
| 835. 特願 2003-121780 | 885. 特願 2003-170327 |
| 836. 特願 2003-122245 | 886. 特願 2003-170328 |
| 837. 特願 2003-123984 | 887. 特願 2003-170329 |
| 838. 特願 2003-124654 | 888. 特願 2003-170330 |
| 839. 特願 2003-124655 | 889. 特願 2003-170573 |
| 840. 特願 2003-124826 | 890. 特願 2003-171576 |
| 841. 特願 2003-124829 | 891. 特願 2003-171619 |
| 842. 特願 2003-124833 | 892. 特願 2003-172898 |
| 843. 特願 2003-124835 | 893. 特願 2003-175819 |
| 844. 特願 2003-125388 | 894. 特願 2003-177298 |
| 845. 特願 2003-125403 | 895. 特願 2003-180198 |
| 846. 特願 2003-125405 | 896. 特願 2003-182958 |
| 847. 特願 2003-127090 | 897. 特願 2003-192763 |
| 848. 特願 2003-127093 | 898. 特願 2003-192775 |
| 849. 特願 2003-127109 | 899. 特願 2003-194837 |
| 850. 特願 2003-127130 | 900. 特願 2003-197229 |

目 録 (10)

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 901. 特願 2003-198340 | 951. 特願 2003-338191 |
| 902. 特願 2003-204075 | 952. 特願 2003-339542 |
| 903. 特願 2003-205349 | 953. 特願 2003-340181 |
| 904. 特願 2003-205710 | 954. 特願 2003-342519 |
| 905. 特願 2003-206546 | |
| 906. 特願 2003-207698 | |
| 907. 特願 2003-207771 | |
| 908. 特願 2003-207772 | |
| 909. 特願 2003-207850 | |
| 910. 特願 2003-270049 | |
| 911. 特願 2003-271473 | |
| 912. 特願 2003-272421 | |
| 913. 特願 2003-275055 | |
| 914. 特願 2003-277958 | |
| 915. 特願 2003-279130 | |
| 916. 特願 2003-283972 | |
| 917. 特願 2003-284055 | |
| 918. 特願 2003-286640 | |
| 919. 特願 2003-289138 | |
| 920. 特願 2003-293912 | |
| 921. 特願 2003-296474 | |
| 922. 特願 2003-298558 | |
| 923. 特願 2003-299424 | |
| 924. 特願 2003-303979 | |
| 925. 特願 2003-304452 | |
| 926. 特願 2003-304453 | |
| 927. 特願 2003-305689 | |
| 928. 特願 2003-305844 | |
| 929. 特願 2003-306137 | |
| 930. 特願 2003-307564 | |
| 931. 特願 2003-313014 | |
| 932. 特願 2003-315355 | |
| 933. 特願 2003-318801 | |
| 934. 特願 2003-321497 | |
| 935. 特願 2003-322948 | |
| 936. 特願 2003-324974 | |
| 937. 特願 2003-326510 | |
| 938. 特願 2003-327045 | |
| 939. 特願 2003-327907 | |
| 940. 特願 2003-328600 | |
| 941. 特願 2003-328840 | |
| 942. 特願 2003-330418 | |
| 943. 特願 2003-330569 | |
| 944. 特願 2003-331848 | |
| 945. 特願 2003-332756 | |
| 946. 特願 2003-333798 | |
| 947. 特願 2003-333932 | |
| 948. 特願 2003-334036 | |
| 949. 特願 2003-334083 | |
| 950. 特願 2003-336365 | |

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-170051
受付番号	20308550874
書類名	出願人名義変更届（一般承継）
担当官	塩野 実 2151
作成日	平成16年 3月17日

<認定情報・付加情報>

【提出された物件の記事】

【提出物件名】	委任状（代理権を証明する書面）	1
---------	-----------------	---



特願 2003-170051

出願人履歴情報

識別番号 [000006792]

1. 変更年月日	1990年 8月28日
[変更理由]	新規登録
住 所	埼玉県和光市広沢2番1号
氏 名	理化学研究所

特願 2 0 0 3 - 1 7 0 0 5 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[5 0 3 3 5 9 8 2 1]

1. 変更年月日

2 0 0 3 年 1 0 月 1 日

[変更理由]

新規登録

住 所

埼玉県和光市広沢 2 番 1 号

氏 名

独立行政法人理化学研究所

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.